



Certificate of Mailing

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service on the date shown below with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to the: Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C. 20231.

Date: June 25, 2001

Sonia V. McVean
Sonia V. McVean

12862
PZ4
BT
01-25-02
RECEIVED
U.S. MAIL ROOM
JUN 25 2001

PATENT
36856.472

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of: Hajime KANDOU et al. Serial No.: 09/840,359 Filing Date: April 23, 2001 For: SURFACE ACOUSTIC WAVE DEVICE	Art Unit: 2862 Examiner: Unknown
--	---

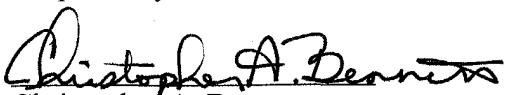
TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENTS

ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTS
Washington, D.C. 20231

Dear Sir:

Enclosed herewith is a certified copy each of Japanese Patent Application No. **2000-130168** filed **April 28, 2000**, 1999, and from which priority is claimed under 35 U.S.C. 119 and Rule 55b. Acknowledgement of the priority documents is respectfully requested to ensure that the subject information appears on the printed patent.

Respectfully submitted,


Christopher A. Bennett
Attorney for Applicant(s)
Reg. No. 46,710

KEATING & BENNETT LLP
10400 Eaton Place, Suite 312
(703) 385-5200



日本特許庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2000年 4月 28日

出願番号
Application Number: 特願 2000-130168

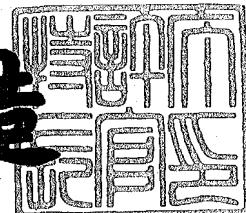
出願人
Applicant(s): 株式会社村田製作所

RECEIVED
JUN 5 2001
TE 2900 MAIL ROOM

2001年 3月 9日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特 2001-3016120

【書類名】 特許願

【整理番号】 DP000089

【提出日】 平成12年 4月28日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H03H 9/145

【発明者】

【住所又は居所】 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田
製作所内

【氏名】 神藤 始

【発明者】

【住所又は居所】 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田
製作所内

【氏名】 門田 道雄

【特許出願人】

【識別番号】 000006231

【住所又は居所】 京都府長岡京市天神二丁目26番10号

【氏名又は名称】 株式会社村田製作所

【代理人】

【識別番号】 100086597

【弁理士】

【氏名又は名称】 宮▼崎▲ 主税

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 004776

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 表面波装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 水晶基板と、前記水晶基板上に形成された圧電薄膜と、前記水晶基板と前記圧電薄膜間に形成されたくし歯電極とを備え、前記圧電薄膜の膜厚をH、表面波の波長をλとしたときに、圧電薄膜の規格化膜厚H/λが0.05以上とされていることを特徴とする、表面波装置。

【請求項2】 前記圧電薄膜の規格化膜厚H/λが0.20以上とされている、請求項1に記載の表面波装置。

【請求項3】 前記圧電薄膜がマイナス面で前記基板及び/またはくし歯電極に接している、請求項1または2に記載の表面波装置。

【請求項4】 前記圧電薄膜上に形成された短絡電極をさらに備える、請求項1～3のいずれかに記載の表面波装置。

【請求項5】 前記水晶基板のオイラー角が、図6におけるレイリー波のパワーフロー角PFAが±2.5°となる範囲にある、請求項1～4のいずれかに記載の表面波装置。

【請求項6】 前記水晶基板のオイラー角が、図7における表面波装置の周波数温度係数TCFが±25ppm/°Cとなる範囲にある、請求項1～4のいずれかに記載の表面波装置。

【請求項7】 前記水晶基板のオイラー角が、図7における表面波装置の周波数温度係数TCFが±5ppm/°Cとなる範囲にある、請求項6に記載の表面波装置。

【請求項8】 前記水晶基板のオイラー角が、図8におけるレイリー波の電気機械結合係数K²が0.8%以上の範囲にある、請求項1～7のいずれかに記載の表面波装置。

【請求項9】 前記水晶基板のオイラー角が、図9におけるスプリアス波の電気機械結合係数K_{SP}²が0.1%以下の範囲にある領域にある、請求項1～7のいずれかに記載の表面波装置。

【請求項10】 前記圧電薄膜の周波数温度係数TCFがマイナスの値を有

する、請求項1～9のいずれかに記載の表面波装置。

【請求項11】 前記水晶基板のオイラー角が、図18における利用しようとする表面波と利用しない不要表面波のパワーフロー角の差△PFAが±1°となる範囲にある、請求項1～10のいずれかに記載の表面波装置。

【請求項12】 前記圧電薄膜が、ZnO、AlN、Ta₂O₅及びCdSからなる群から選択した1種からなる、請求項1～11のいずれかに記載の表面波装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、水晶基板を用いた表面波装置に関し、特に、水晶基板上に圧電薄膜を積層してなる表面波基板を用いた表面波装置の改良に関する。

【0002】

【従来の技術】

従来、例えば移動体通信機器の帯域フィルタなどに表面波装置が広く用いられている。表面波（以下、SAW）装置は、圧電体と接するように少なくとも一対のくし歯電極を形成してなる少なくとも1つのインターデジタルトランスデューサ（以下、IDT）を形成した構造を有する。

【0003】

また、近年、圧電薄膜を用いたSAW装置も種々提案されている。すなわち、ガラス基板や圧電基板などの弹性体基板上に圧電薄膜を形成してなる表面波基板を用いたSAW装置が提案されている。

【0004】

上記圧電薄膜及び弹性体基板を積層してなる表面波基板を用いた構成では、図22（a）及び（b）並びに図23（a）及び（b）に示す4種類の構造が知られている。すなわち、図22（a）に示すSAW装置101では、弹性体基板102上に圧電薄膜103が形成されており、圧電薄膜103上にIDT104が形成されている。他方、図22（b）に示すSAW装置105では、IDT104が圧電薄膜103の下面に、すなわち弹性体基板102と圧電薄膜103との

間の界面に形成されている。

【0005】

また、図23(a)に示すSAW装置106では、弹性体基板102上に、短絡電極107が形成されており、該短絡電極107上に圧電薄膜103が積層されている。IDT104は、圧電薄膜103上に形成されている。すなわち、SAW装置106は、図22(a)に示したSAW装置101において、弹性体基板102と圧電薄膜103との界面に短絡電極107を挿入した構造に相当する。

【0006】

図23(b)に示すSAW装置108では、短絡電極107が圧電薄膜103上に形成されている。また、IDT104が弹性体基板102と圧電薄膜103との間の界面に形成されている。従って、SAW装置108は、図22(b)に示したSAW装置105において、圧電薄膜103の上面に短絡電極107を形成した構造に相当する。

【0007】

上記SAW装置101, 105, 106, 108を、IDT104の形成位置及び短絡電極107の有無のみを異ならせ、他の構成は同一とし、圧電薄膜としてZnO薄膜、弹性体基板としてガラス基板を用いた場合の電気機械結合係数を図24に示す。

【0008】

図24では、上記4種類のSAW装置におけるZnO薄膜の規格化された膜厚H/λに対する電気機械結合係数の変化が示されている。なお、本明細書において、Hは圧電薄膜の厚みを、λは励振される表面波の波長を示す（単位はいずれも同じ）。

【0009】

また、実線AがSAW装置101の結果を、破線BがSAW装置105の結果を、一点鎖線CはSAW装置106の結果を、二点鎖線DがSAW装置108の結果を示す。

【0010】

図24から明らかなように、H/λを選択することにより、SAW装置105, 108において、SAW装置101, 106に比べて大きな電気機械結合係数の得られることがわかる。

【0011】

従って、従来、ガラス基板102上にZnO薄膜103を形成した構造では、IDT104をガラス基板102とZnO薄膜103との間の界面に形成したほうが大きな電気機械結合係数が得られるとされていた。なお、図24中のセザワ波と記載してある波は、レイリー波の高次モードの表面波である。

【0012】

また、IEEE ULTRASONICS SYMPOSIUM (1997) 261~266頁や日本学術振興会弹性波素子技術第150委員会59回研究資料(1998)23~28頁〔以下、文献1と略す。〕には、本発明者により、水晶基板上にZnO薄膜を形成してなる表面波基板を用いた場合の弹性表面波の各種特性が示されている。図25(a)及び(b)並びに図26を参照してこれを説明する。この先行技術には、周波数時間温度特性TCFがプラスの値をもつカット角及び伝搬方向の水晶基板上に、周波数温度係数TCFがマイナスのZnO薄膜を形成することにより、TCFがゼロである表面波基板が得られることが理論と実験とにより確認されている。

【0013】

なお、この文献1における理論は、IEEE trans. Sonics & Ultrason. vol. SU-15, No. 4 (1968) 209頁～に基づいている。

【0014】

図25(a)は、上記文献1に記載されている29°45'回転Y板35°X伝搬〔オイラー角(0°, 119°45', 35°)〕の水晶基板における図22(a)のSAW装置のTCFのZnO膜厚依存性を示し、図25(b)は、上記文献1に記載されている42°45'回転Y板35°X伝搬〔オイラー角(0°, 132°45', 35°)〕における図22(a)のSAW装置のTCFのZnO膜厚依存性を示す。また、図26は、圧電薄膜としてZnO薄膜、弹性体

基板として水晶基板を用いた SAW 装置のレイリー波とスプリアス波であるセザワ波の電気機械結合係数を示す。図 26 における実線 A～C は、それぞれ、図 22 (a)、図 22 (b) 及び図 23 (a) に示す構造の SAW 装置のレイリー波の電気機械結合係数を示し、破線 A''、C'' 及び D'' は、図 22 (a)、図 23 (a) 及び図 23 (b) の構造を有する SAW 装置におけるスプリアスとなるセザワ波の電気機械結合係数の変化を示す。

【0015】

図 25 (a) 及び (b) から、図 22 (a) の SAW 装置では、規格化された ZnO 膜の膜厚を選択することにより、TCF がゼロとなることがわかる。

下記の表 1 は、上述した先行技術に記載の図 22 (a) の SAW 装置 (A1/ZnO / 水晶の積層構造) と、従来より知られている TCF の良好な SAW 装置との比較を示す。

【0016】

【表 1】

基板	基板のオイラー角	音速 (m/s)	K ² (%)	-20～80°Cにおける 周波数温度偏差 (ppm/°C)
A1/ST-X 水晶	(0°、132° 45'、0°)	3158	0.14	0. 9
A1/La ₃ Ga ₅ SiO ₁₄	(0°、143°、24°)	2756	0.42	1. 63
A1/Li ₂ B ₄ O ₇	(110°、90°、90°)	3480	1	6. 8
A1/ZnO / 水晶	(0°、119° 45'、35°) (0°、132° 45'、35°)	2900	1.0~1.1	1. 1

【0017】

図 26 及び表 1 から、図 22 (a) の SAW 装置は、ST-X 水晶基板や La₃Ga₅SiO₁₄ 基板よりも大きい、1% 程度の電気機械結合係数 K² が得られ、同等の電気機械結合係数 K² を有する Li₂B₄O₇ 基板に比べて、音速が 20% 程度低いことがわかる。このことは、図 22 (a) の SAW 装置により、トランズバーサル型 SAW フィルタを構成した場合、ST-X 水晶基板や La₃Ga₅SiO₁₄ 基板の場合よりも低損失であり、Li₂B₄O₇ 基板の場合よりも小型でか

つ温度による周波数偏差が小さいことを意味している。

【0018】

ところで、図26において、圧電薄膜としてZnO薄膜、弹性体基板として水晶基板を用いた場合、図22(b)のSAW装置におけるレイリー波の電気機械結合係数は、図22(a)及び図23(a)のSAW装置におけるレイリー波の電気機械結合係数よりも小さいことが示されており、この傾向は弹性体基板としてガラス基板を用いた場合の傾向と反している。

【0019】

このように、図22(a)及び図23(a)のSAW装置は、良好なTCFと大きな電気機械結合係数を併せ持つため、これを用いることにより、移動体通信機器の帯域フィルタなどの表面波装置の高性能化を図ることができる。

【0020】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、図22(a)及び図23(a)のSAW装置においても、なお、電気機械結合係数が不足し、表面波装置に要求される特性を十分に満たすことができないという問題があった。移動体通信では、従来のアナログ方式からデジタル方式、そして符号拡散方式との方式が移行しつつある。例えば、デジタル方式や符号拡散方式に用いられる中間周波数フィルタでは、低群遅延偏差と低挿入損失が要求される。群遅延偏差の小さい表面波装置による帯域フィルタとして、トランスバーサル型フィルタが知られているが、従来の表面波基板でトランスバーサル型フィルタを構成した場合、電気機械結合係数が不足し、上記要求に答えることはできなかった。

【0021】

本発明の目的は、水晶基板及び圧電薄膜を積層してなる表面波基板を用いたSAW装置において、温度特性が良好であり、かつ電気機械結合係数が大きなSAW装置を提供することにある。

【0022】

【課題を解決するための手段】

本発明は、上記課題を達成するために成されたものであり、本願の広い局面に

よれば、水晶基板と、前記水晶基板上に形成された圧電薄膜と、前記水晶基板と前記圧電薄膜間に形成されたくし歯電極とを備え、前記圧電薄膜の膜厚をH、表面波の波長をλとしたときに、圧電薄膜の規格化膜厚H/λが0.05以上とされていることを特徴とする、表面波装置が提供される。

【0023】

本発明のある特定の局面では、圧電薄膜の規格化膜厚H/λは0.20以上とされている。

本発明の別の特定の局面では、圧電薄膜がマイナス面で前記基板及び/またはくし歯電極に接しているように構成される。

【0024】

本発明のさらに他の特定の局面では、圧電薄膜上に形成された短絡電極がさらに備えられる。

本発明の別の特定の局面では、水晶基板のオイラー角が、図6におけるレイリーワークのパワーフロー角PFAが±2.5°となる範囲にある。

【0025】

本発明の他の特定の局面では、水晶基板のオイラー角が、図7における表面波装置の周波数温度係数TCFが±25 ppm/°Cとなる範囲にある。

本発明の他の特定の局面では、水晶基板のオイラー角が、図7における表面波装置の周波数温度係数TCFが±5 ppm/°Cとなる範囲にある。

【0026】

本発明の他の特定の局面では、水晶基板のオイラー角が、図8におけるレイリーワークの電気機械結合係数K²が0.8%以上となる範囲にある。

本発明の特定の局面では、水晶基板のオイラー角が、図9におけるスプリアス波の電気機械結合係数K_{SP}²が0.1%以下となる範囲にある。

【0027】

本発明の別の特定の局面では、圧電薄膜の周波数温度係数TCFがマイナスの値を有する。

本発明の別の特定の局面では、水晶基板のオイラー角が、図18における利用しようとする表面波と利用しない不要表面波のパワーフロー角の差△PFAが±

1° となる範囲にある。

本発明において、上記圧電薄膜は、好ましくは、ZnO、AlN、Ta₂O₅及びCdSからなる群から選択した1種により構成される。

【0028】

【発明の実施の形態】

図1 (a) 及び (b) は、本発明の一実施例に係る表面波装置を示す平面図及び要部を拡大して示す部分切欠正面断面図である。

【0029】

表面波装置1では、水晶基板2上に、インダクターデジタルトランスデューサ(IDT)3, 4が形成されている。IDT3, 4は、それぞれ、一対のくし歯電極3a, 3b, 4a, 4bを有する。IDT3, 4は表面波伝搬方向において所定距離を隔てて配置されている。すなわち、本実施例の表面波装置1は、周知のトランスバーサル型表面波フィルタと同様にIDT3, 4が構成されている。

【0030】

本実施例の特徴は、IDT3, 4を覆うように、圧電薄膜5が積層されており、該圧電薄膜5の膜厚をH、表面波波長をλとしたときに、圧電薄膜5の規格化膜厚H/λが0.05以上とされていることにあり、それによって電気機械結合係数K²が大きくされており、かつ温度特性も良好とされている。これを、以下においてより詳細に説明する。

【0031】

本願発明者らは、弾性体基板として水晶基板を用い、該水晶基板上に圧電薄膜としてZnO薄膜を形成してなる表面波基板を用いた表面波装置、特に前述した図22 (b) 及び図23 (b) に示した積層構造を有する表面波装置の特性について、弾性体基板としてガラス基板を用いた場合の傾向と反対であることに疑念を抱き、前述した先行技術とは別の角度から検討した。

【0032】

図2及び図3は、圧電薄膜としてZnO薄膜、弾性体基板としてオイラー角(0, 119° 45'、35°)のX伝搬水晶基板を用いた場合の、図22 (a), (b) 及び図23 (a), (b) の構造を有する各SAW装置を伝搬するレイ

リー波における、ZnO薄膜の規格化された厚みと、電気機械結合係数との関係を示し、図4及び図5は、レイリー波近傍に発生するスプリアス波における、ZnO薄膜の規格化された厚みと電気機械結合係数の関係を示す。

【0033】

なお、図2及び図4では、ZnO薄膜のオイラー角は(0°、0°、0°)とし、図3及び図5では、ZnO薄膜のオイラー角は(0°、180°、0°)とし、ZnO薄膜の極性を反転している。

【0034】

ここで、図2～図5の結果は、上記先行技術に記載のcambellらの手法ではなく、文献(電子通信学会論文誌Vol. J68-C No1(1985)21～27頁)に提案されている有限要素法を利用して求め、電気機械結合係数 K^2 は、上記有限要素法により自由表面の音速 V_f と、短絡表面の音速 V_m とを導出し、下記の式(1)により求めた。

$$K^2 = 2 \times (V_f - V_m) / V_f \cdots \text{式(1)}$$

【0035】

図2～図5において、図22(b)のSAW装置のレイリー波のZnO薄膜の厚さが0.05λを超えると、ZnO薄膜を形成しない場合に比べて電気機械結合係数 K^2 は大きくなる。

【0036】

また、上記ZnO薄膜の厚みが0.20λ～0.24λの範囲を超えると、図22(b)のSAW装置のレイリー波の電気機械結合係数 K^2 は、図22(a)及び図23(a)及び(b)のSAW装置のレイリー波の電気機械結合係数 K^2 よりも大きくなる。特に、ZnO薄膜の厚みが0.5λ付近では、図22(a)のSAW装置のレイリー波の電気機械結合係数の3倍に達する。

【0037】

また、ZnO薄膜の厚みが0.27λ～0.31λの範囲を超えると、図23(b)のSAW装置のレイリー波の電気機械結合係数は、図22(a)及び図23(a)のSAW装置におけるレイリー波の電気機械結合係数よりも大きくなる。

【0038】

以上の計算結果は、弾性体基板としてガラス基板を用いた場合の図24の結果と同様であり、図25に示した前述した文献1における理論値とは傾向が異なる。

【0039】

また、ZnO薄膜のオイラー角を(0°、0°、0°)とした場合は、ZnO薄膜のオイラー角を(0°、180°、0°)とした場合よりも、レイリー波の電気機械結合係数 K^2 は大きく、スプリアスの電気機械結合係数 K^2 が小さい傾向がある。

【0040】

以上の計算により、図22(b)及び図23(b)の構造のSAW表面波装置を、水晶基板上にZnO薄膜を形成してなる表面波基板を用いることにより、電気機械結合係数 K^2 を大幅に高め得ることがわかる。

【0041】

ところで、表面波基板の代表的な評価項目としては、電気機械結合係数 K^2 だけでなく、パワーフロー角PFA及び周波数温度特性TCFが挙げられる。また、圧電薄膜としてZnO薄膜を、弾性体基板として水晶基板を用いた図22(a)～図23(b)に示した各積層構造を有するSAW装置では、レイリー波の110%程度の音速を持つスプリアス波が生じる。従って、スプリアス波の電気機械結合係数 K_{SP}^2 も重要な評価項目となる。

【0042】

すなわち、表面波基板では、PFA、TCF及び K_{SP}^2 が小さいことが望ましい。

そこで、弾性体基板として水晶基板を用い、圧電薄膜としてZnO薄膜を用いた図22(b)の構造、すなわち図1(b)と同じ構造のSAW装置において、水晶基板のオイラー角(0°、θ、φ)及びZnO薄膜の厚み、レイリー波のパワーフロー角PFA、周波数温度係数TCF、レイリー波の電気機械結合係数 K^2 と、スプリアス波の電気機械結合係数 K_{SP}^2 との関係を、有限要素法を用いて計算した。結果を、図6～図9、図10～図13及び図14～図17を参照して

説明する。

【0043】

図6～図9は、ZnO/A1/水晶基板を伝搬する表面波の基板方位依存性を示す図であり、この場合ZnOの規格化膜厚は0.20λとされている。図6はレイリー波のパワーフロー角、図7はレイリー波の周波数温度係数TCF、図8はレイリー波の電気機械結合係数 K^2 を、図9はスプリアス波の電気機械結合係数 K_{SP}^2 の方位依存性をそれぞれ示す。

【0044】

図6～図9の等高線は、それぞれ、上記パワーフロー角PFA、周波数温度係数TCF、電気機械結合係数 K^2 及び K_{SP}^2 が同じ部分であることを意味する。図10～図13及び図14～図17も同様の結果を示すものであるが、図10～図13はZnO膜の規格化膜厚が0.25λとされており、図14～図17では、ZnO膜の規格化膜厚が0.30λとされている。

【0045】

図6～図17において、斜線が交差しているハッチングで示す各矢印Xで示す領域は、電気機械結合係数 K^2 が小さいなどの理由により計算値が得られなかつた条件である。図6、図10、図14及び図7、図11、図15におけるPFA及びTCFは下記の式(2)及び(3)によりそれぞれ求めた値である。

【0046】

$$PFA = \tan^{-1} (Vf^{-1} \times \partial Vf / \partial \phi) \cdots \text{式(2)}$$

$$TCF = Vf^{-1} \times \partial Vf / \partial T - \alpha \cdots \text{式(3)}$$

式(2)において、 ϕ は表面波の伝搬方向(度)、Tは温度(°C)、 α は表面波の伝搬方向における熱膨張係数を示す。

【0047】

図6、図10及び図14より、パワーフロー角PFAが、-2.5～+2.5°と小さい条件は、図6の太線Y1、Y2で囲まれた斜線のハッチングを付した領域であることがわかる。

【0048】

また、図7、図11、図15より、周波数温度係数TCFが、-25～+25

$\text{ppm}/^\circ\text{C}$ と小さい条件は、図7の線T1, T2で囲まれており、かつ斜線のハッチングを付して示した領域であることがわかる。特に、 $\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7$ 基板よりも小さい $-5 \sim +5 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ となる条件は、図7の線T3, T4、図11の線T5, T6、図15の線T7, T8で囲まれた領域であることがわかる。

【0049】

また、電気機械結合係数 K^2 は、前述のように ZnO 膜厚を 0.05λ 以上とすれば ZnO 薄膜を形成しない場合に比べて大きくできるが、オイラー角を調整することでさらなる改善が可能となる。例えば、図8において、太線Kで囲んだ範囲は結合係数が 0.8% 以上となり、従来の図22(a)のSAW装置の結合係数と同等もしくはそれ以上の値を示す。 ZnO 膜厚を増加すると全てのオイラー角で結合係数が増加するが、特定の膜厚において、結合係数の大きい範囲は図8の太線Kで囲まれた範囲となる。

【0050】

さらに、図9、図13及び図17から、スプリアス波の電気機械結合係数 K_{SP}^2 が $0 \sim 0.1$ と小さい条件は、太線S1, S2, S3で囲まれた領域であることがわかる。

【0051】

従って、水晶基板上に圧電薄膜が形成されており、該水晶基板と圧電薄膜との間にくし歯電極が形成されている図1(b)の構造を有する表面波装置において、上記水晶基板のオイラー角を、上述した各範囲に設定することにより、PFA、TCF及び K_{SP}^2 が小さく、レイリー波の電気機械結合係数 K^2 が大きい表面波装置を提供し得ることがわかる。

【0052】

次に、具体的な実験例につき説明する。

ところで、パワーフロー角とは、表面波の位相速度の方向と群速度の方向の差を示す角度であり、パワーフロー角が存在する場合、表面波のエネルギーはくし歯電極の電極指の垂線方向に対し、パワーフロー角だけずれて伝搬する。このときの表面波エネルギーの損失 L_{PFA} は、下記の式(4)で表される。

【0053】

$$L_{PFA} = 10 \times \log_{10} [\{ W - \tan(PFA) \} / W] \quad (\text{dB} / \lambda)$$

…式 (4)

式 (4) において、Wは表面波の波長を λ で規格化されたくし歯電極の交差幅を示す。

【0054】

従って、前述したように、表面波基板ではパワーフロー角PFAは 0° であることが望ましい。しかしながら、PFAが存在する場合、くし歯電極の設計難度は高くなるが、図21に示すように、表面波基板11上におけるくし歯電極12の電極指配置角 θ_{strip} と、PFAとを一致させることにより、 θ_{strip} とPFAとの差に起因する挿入損失の劣化を抑制することができる。反対に、電極指の配置角度とPFAが異なっていると、挿入損失は劣化することになる。

【0055】

本発明に係る表面波基板では、レイリー波の110%程度の音速を有するスプリアス波が存在する。電極指配置角度 θ_{strip} を、レイリー波のパワーフロー角PFAと一致させた上記くし歯電極では、レイリー波とスプリアス波のパワーフロー角の差を ΔPFA とすると、 ΔPFA に起因するスプリアス波の損失 L_{PFASP} は式 (4) と同様に、下記の式 (5) により表される。

【0056】

$$L_{PFASP} = 10 \times \log_{10} [\{ W - \tan(\Delta PFA) \} / W] \quad (\text{dB} / \lambda)$$

…式 (5)

式 (5) より、 ΔPFA を大きくすることにより、スプリアス波の応答を抑圧し得ることがわかる。例えば、 $W = 10\lambda$ のくし歯電極において、表面波が 200λ 伝搬すると、 ΔPFA が 1° の場合、 1.5 dB 程度スプリアス波を抑圧することができる。

【0057】

図18～図20は、 ΔPFA の基板依存性を示す図である。図18～図20は、図6～図17の場合と同様に、ZnO/A1/水晶基板の構造のSAW装置において、ZnO膜の厚みを 0.20λ 、 0.25λ 及び 0.30λ とした場合のそれぞれ ΔPFA の基板依存性を示す。図18～図20における等高線は、 ΔP

F Aが同じ値であることを示し、図18～図20より、△PFAが±1°以上となる条件は、図18の線Pであることがわかる。

【0058】

本発明の基本原理は、前述した文献1に記載のように、周波数温度特性TCFがプラスの値を有するカット角及び伝搬方向の水晶基板上に、TCFがマイナスの値を有する圧電薄膜を形成することにより、水晶基板の温度特性と圧電薄膜の温度特性とを相殺し、良好な周波数温度特性を得ることにある。従って、好ましくは、上記圧電薄膜としては、TCFがマイナスの値を有するものが用いられる。

【0059】

なお、上記実施例では、圧電薄膜として、ZnO薄膜を形成した場合につき説明したが、ZnO薄膜の他、TCFがプラスである圧電薄膜、例えばAlN、Ta₂O₅またはCdSなどからなる圧電薄膜を用いてもよい。

【0060】

さらに、水晶基板については、圧電薄膜が積層される側の面がプラス面及びマイナス面のいずれであってもよい。

また、水晶基板上に圧電薄膜を形成した場合の弾性表面波は、若干SH方向の変位成分を有することがあるが、本願明細書においては、便宜上、このようにレイリー波が変形した弾性表面波を含めてレイリー波と称していることを指摘しておく。

【0061】

また、本願に示した計算値はZnO薄膜の緻密性が良好な条件での計算値である。ZnO膜の緻密性が低い場合は、ZnO膜の膜厚が薄い場合の計算値と近い値となることを指摘しておく。

【0062】

【発明の効果】

本発明に係る表面波装置では、水晶基板上に圧電薄膜が形成されており、該水晶基板と圧電薄膜間にくし歯電極が形成されており、圧電薄膜の規格化膜厚H/λが0.05以上とされているので、レイリー波の電気機械結合係数K²が大き

い表面波装置を提供することができる。

【0063】

特に、圧電薄膜の規格化膜厚 H/λ が0.20以上の場合には、レイリー波の電気機械結合係数 K^2 をより一層大きくすることができる。

圧電薄膜がマイナス面で、水晶基板及び／またはくし歯電極に接している場合には、すなわち圧電薄膜のプラス面が上面となるように構成することにより、電気機械結合係数 K^2 をさらに大きくすることができる。

【0064】

また、圧電薄膜上に短絡電極がさらに形成されていてもよく、その場合においても、本発明に従って電気機械結合係数 K^2 の大きな表面波装置を構成することができる。

【0065】

また、水晶基板のオイラー角が、図6の線Y1, Y2で囲まれた範囲にある場合には、パワーフロー角を±2.5°とすることができる。

水晶基板のオイラー角が、図7の線T1, T2で囲まれた範囲の場合には、表面波装置の周波数温度係数 TCF を±25 ppm/°Cとすることができます、温度依存性の少ない表面波装置を提供することができる。特に、水晶基板のオイラー角が図7の線T3, T4で囲まれた範囲にある場合には、表面波装置の周波数温度係数 TCF を±5 ppm/°Cとすることができます。

【0066】

さらに、水晶基板のオイラー角が、図8の線Kで囲まれた範囲にある場合には、レイリー波の電気機械結合係数 K^2 を0.8%以上とすることができます。

水晶基板のオイラー角が、図9の線S1, S2, S3で囲まれた範囲にある場合には、スプリアス波の電気機械結合係数 K_{SP}^2 を0.1%以下とすることができます、スプリアス波の影響を抑制することができる。

【0067】

圧電薄膜の周波数温度係数 TCF がマイナスの値を有する場合には、水晶基板の周波数温度係数と相殺されて、温度依存性の少ない表面波装置を容易に構成することができる。

【0068】

水晶基板のオイラー角が、図18の線Pで囲まれた範囲にある場合には、利用しようとする表面波と利用しない不要表面波とのパワーフロー角の差 ΔPFA が $\pm 1^\circ$ の範囲とされるので、特性に優れた表面波装置を提供することができる。特に、隣り合うIDT間の距離 L_{11} が、IDTの電極指交差幅をWとしたときに、 $L_{11} > W / \tan(\Delta PFA)$ である場合には、不要表面波の影響をより効果的に抑制することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

(a) 及び (b) は、本発明の一実施例に係る表面波装置を説明するための概略構成図であり、(a) は平面図、(b) は要部断面図。

【図2】

各種積層構造のSAW装置においてオイラー角(0°、119.75°、35°)の水晶基板上にオイラー角(0°、0°、0°)のZnO膜を形成したときのレイリー波のZnO規格化膜厚と電気機械結合係数 K^2 との関係を示す図。

【図3】

各種積層構造のSAW装置においてオイラー角(0°、119.75°、35°)の水晶基板上にオイラー角(0°、180°、0°)のZnO膜を形成したときのレイリー波のZnO規格化膜厚とレイリー波の電気機械結合係数 K^2 との関係を示す図。

【図4】

各種積層構造のSAW装置においてオイラー角(0°、119.75°、35°)の水晶基板上にオイラー角(0°、0°、0°)のZnO膜を形成したときのレイリー波のZnO規格化膜厚とスプリアス波の電気機械結合係数 K_{Sp}^2 との関係を示す図。

【図5】

各種積層構造のSAW装置においてオイラー角(0°、119.75°、35°)の水晶基板上にオイラー角(0°、180°、0°)のZnO膜を形成したときのレイリー波のZnO規格化膜厚とスプリアス波の電気機械結合係数 K_{Sp}^2 との関係を示す図。

との関係を示す図。

【図6】

ZnOの規格化膜厚が0.20λである場合の、レイリー波のパワーフロー角の基板方位依存性を示す図。

【図7】

ZnOの規格化膜厚が0.20λである場合の、レイリー波の周波数温度係数TCFの基板方位依存性を示す図。

【図8】

ZnOの規格化膜厚が0.20λである場合の、レイリー波の電気機械結合係数 K^2 の基板方位依存性を示す図。

【図9】

ZnOの規格化膜厚が0.20λである場合の、スプリアス波の電気機械結合係数 K_{SP}^2 の基板方位依存性を示す図。

【図10】

ZnOの規格化膜厚が0.25λである場合の、レイリー波のパワーフロー角の基板方位依存性を示す図。

【図11】

ZnOの規格化膜厚が0.25λである場合の、レイリー波の周波数温度係数TCFの基板方位依存性を示す図。

【図12】

ZnOの規格化膜厚が0.25λである場合の、レイリー波の電気機械結合係数 K^2 の基板方位依存性を示す図。

【図13】

ZnOの規格化膜厚が0.25λである場合の、スプリアス波の電気機械結合係数 K_{SP}^2 の基板方位依存性を示す図。

【図14】

ZnOの規格化膜厚が0.30λである場合の、レイリー波のパワーフロー角の基板方位依存性を示す図。

【図15】

ZnOの規格化膜厚が0.30λである場合の、レイリー波の周波数温度係数TCFの基板方位依存性を示す図。

【図16】

ZnOの規格化膜厚が0.30λである場合の、レイリー波の電気機械結合係数K²の基板方位依存性を示す図。

【図17】

ZnOの規格化膜厚が0.30λである場合の、スプリアス波の電気機械結合係数K_{SP}²の基板方位依存性を示す図。

【図18】

ZnOの規格化膜厚が0.20λである場合の、ΔPFAの基板方位依存性を示す図。

【図19】

ZnOの規格化膜厚が0.25λである場合の、ΔPFAの基板方位依存性を示す図。

【図20】

ZnOの規格化膜厚が0.30λである場合の、ΔPFAの基板方位依存性を示す図。

【図21】

表面波装置におけるくし歯電極の電極指配置角θ_{strip}とパワーフロー角PFAとの関係を説明するための模式図。

【図22】

(a) 及び (b) は、表面波装置における基板、圧電薄膜及びくし歯電極の積層構造例を説明するための模式的断面図。

【図23】

(a) 及び (b) は、表面波装置における基板、圧電薄膜及びくし歯電極の積層構造例を説明するための模式的断面図。

【図24】

従来の表面波装置におけるZnO薄膜の規格化された膜厚と、電気機械結合係数K_sとの関係を示す図。

【図25】

(a) 及び (b) は、先行技術に記載の表面波装置の ZnO 膜厚に対する周波数温度係数 TCF の依存性を示す図。

【図26】

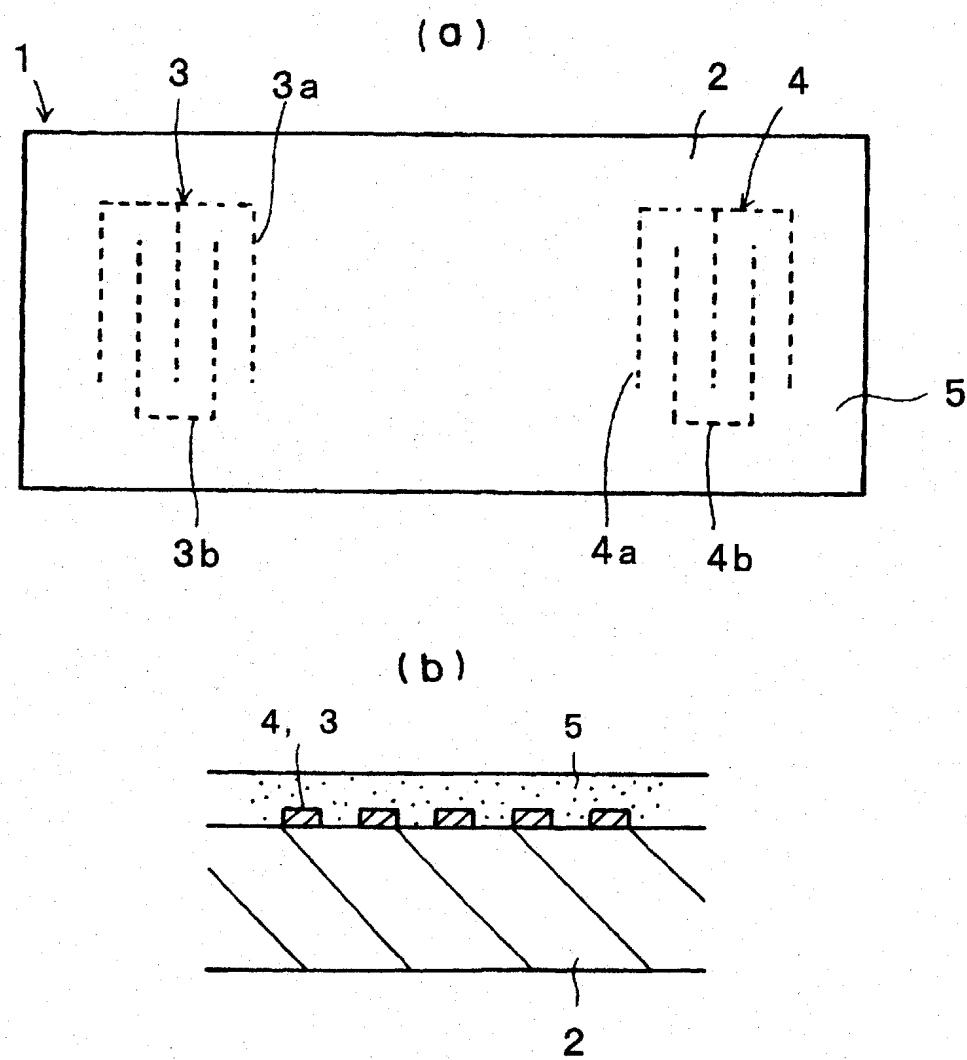
先行技術に記載されている、 ZnO の規格化された膜厚 H/λ と電気機械結合係数との関係を示す図。

【符号の説明】

- 1 … 表面波装置
- 2 … 水晶基板
- 3, 4 … IDT
- 3a, 3b, 4a, 4b … くし歯電極
- 5 … 圧電薄膜

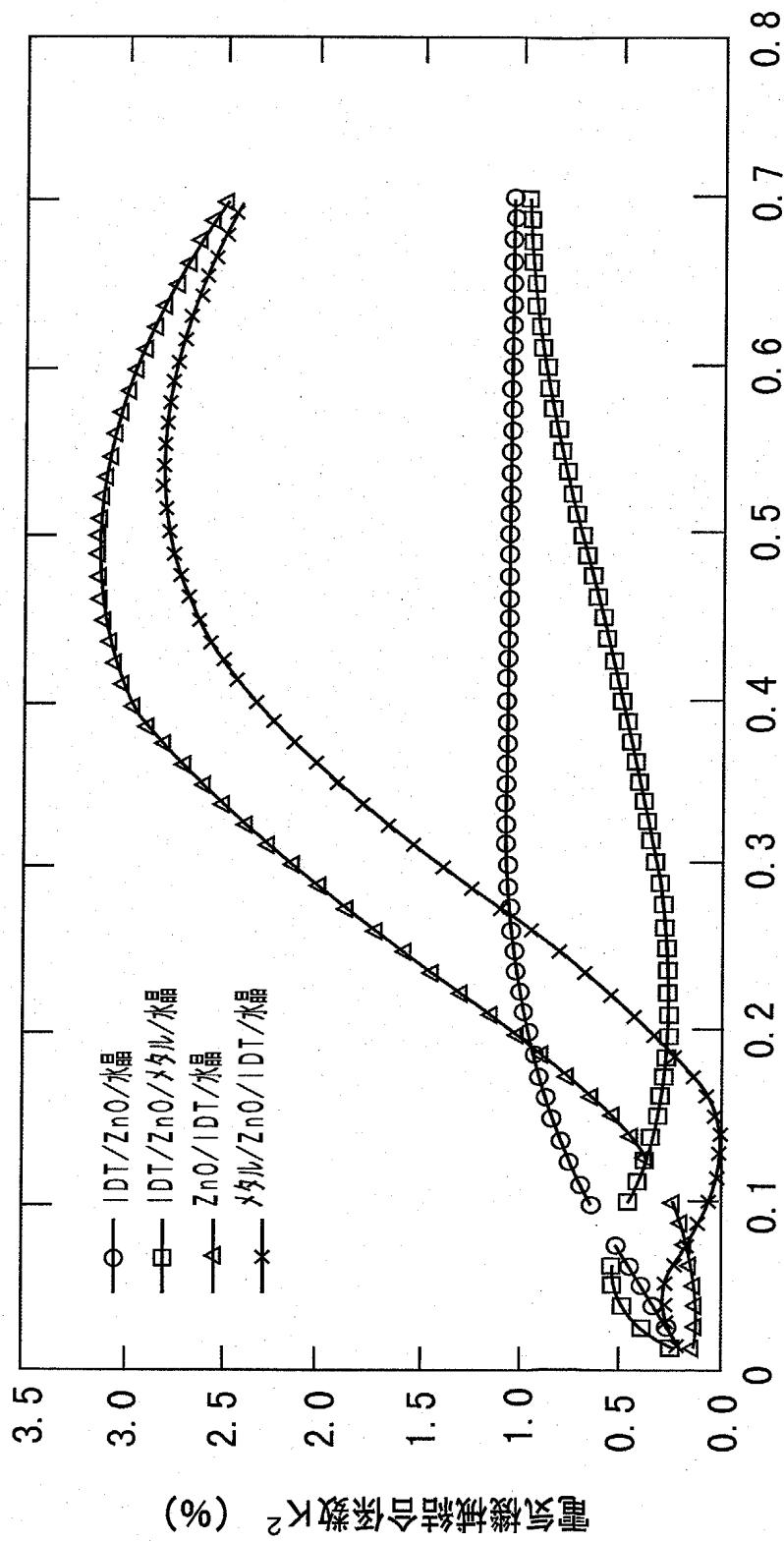
【書類名】図面

【図1】



【図2】

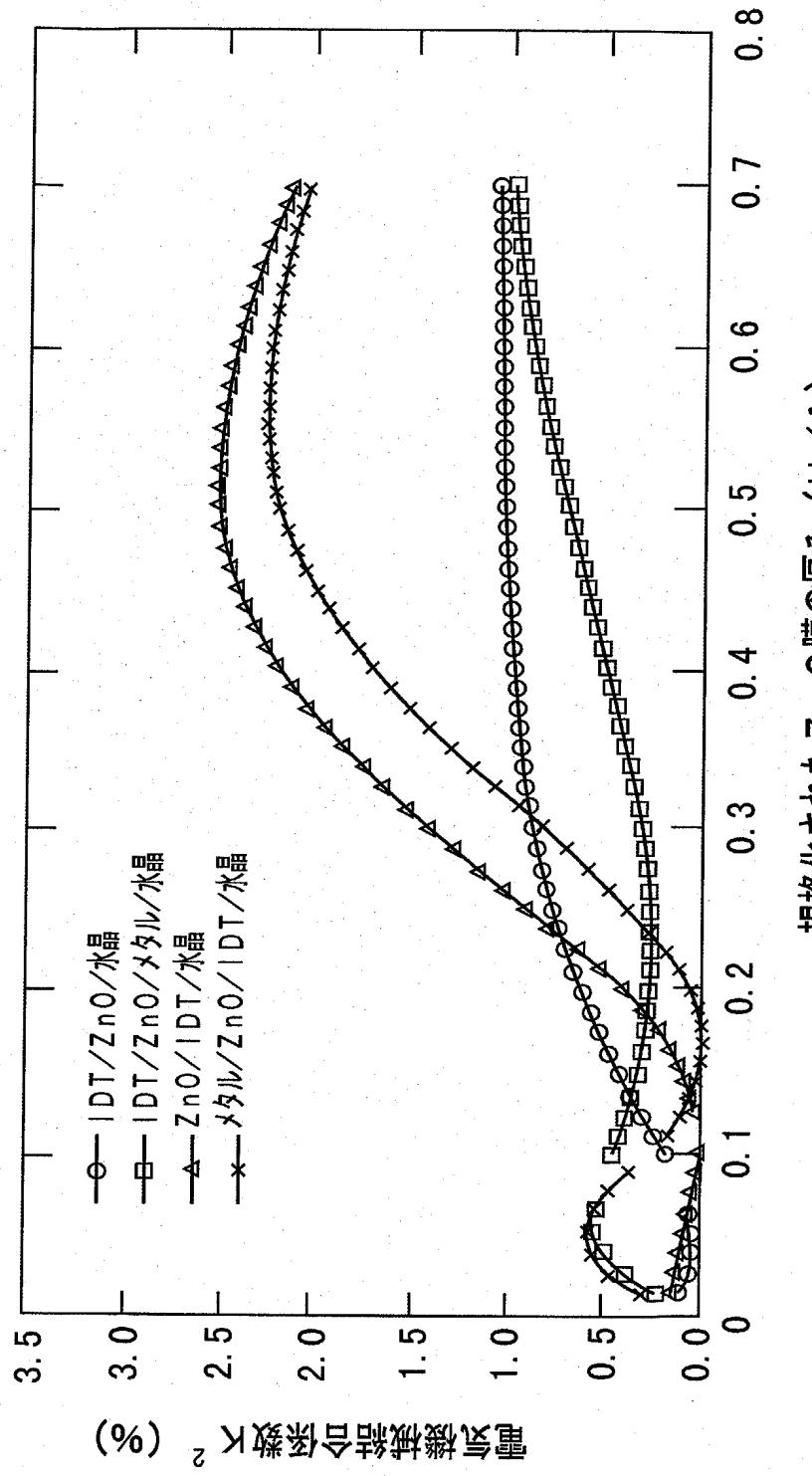
オイラー角(0°、119.75°、35°)の水晶基板上にオイラー角(0°、0°、0°)のZnO薄膜を形成したときのレイリー波の電気機械結合係数 K_2



規格化されたZnO膜の厚み (H/λ)

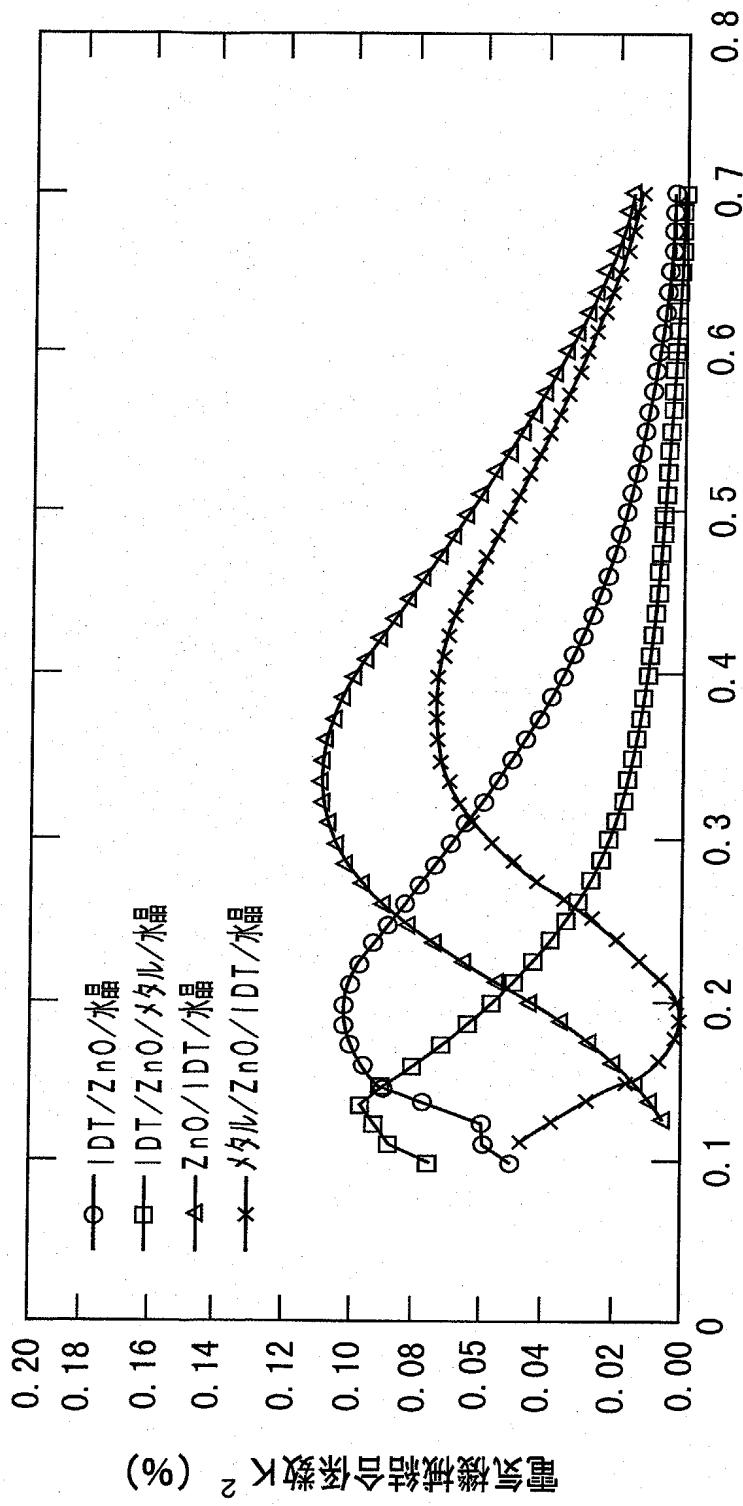
【図3】

オイラー角(0°、119.75°、35°)の水晶基板上にオイラー角(0°、180°、0°)のZnO薄膜を形成したときのレイー波の電気機械結合係数 K_2^2



【図4】

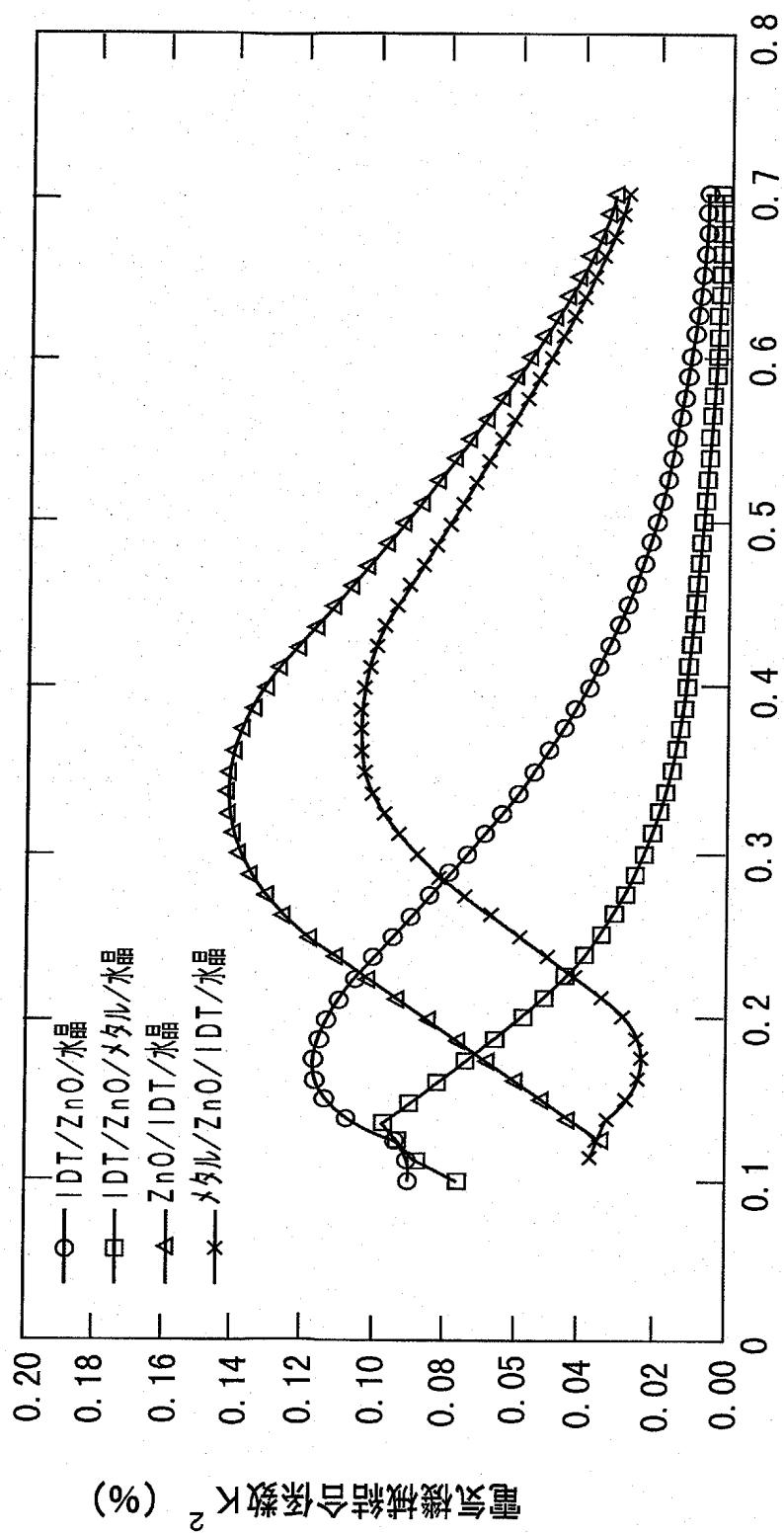
オイラー角(0°、119.75°、35°)の水晶基板上にオイラー角(0°、0°、0°)のZnO薄膜を形成したときのレイリー波の電気機械結合係数 K^2



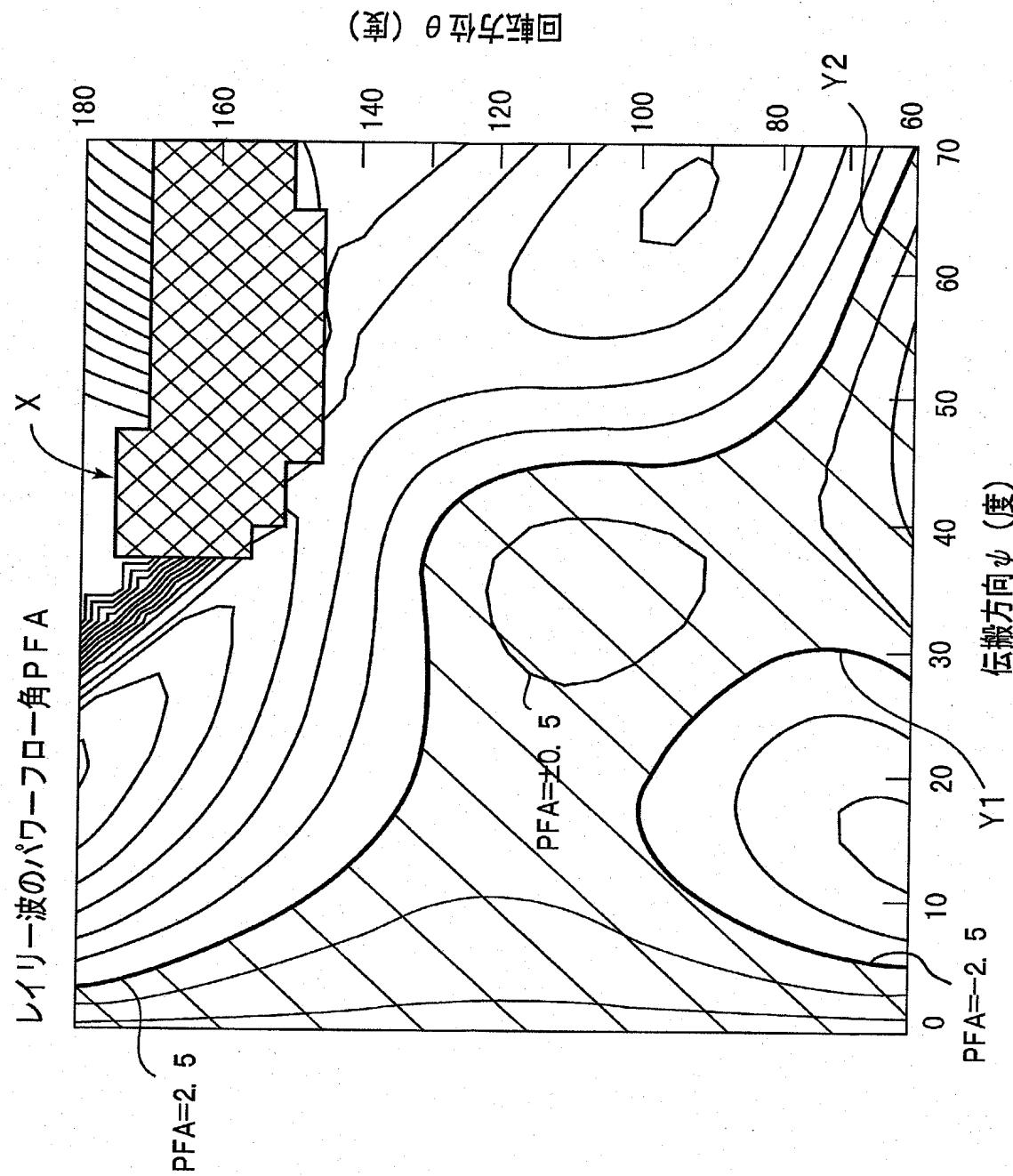
規格化されたZnO膜の厚み (H/λ)

図5】

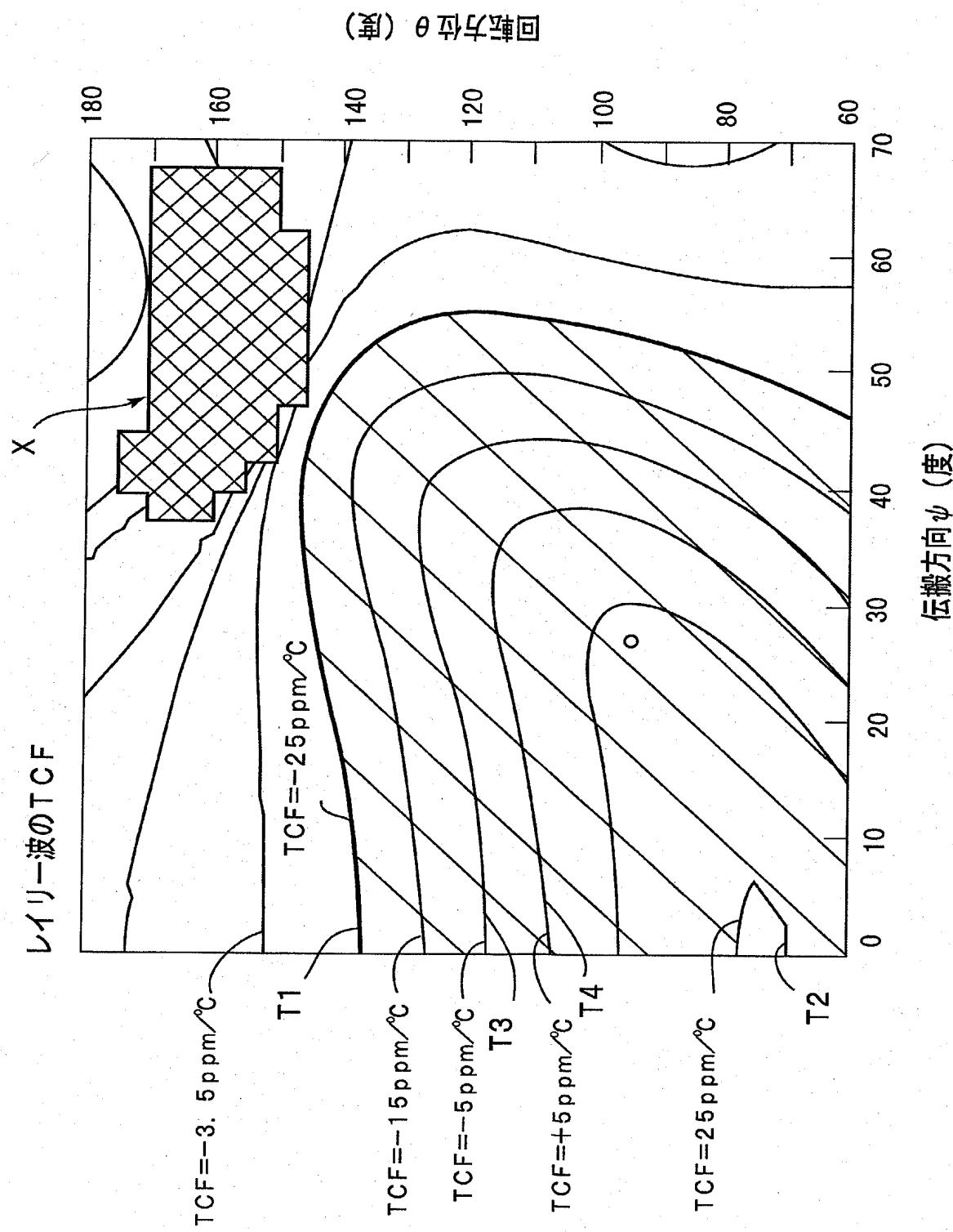
オイラー角(0°、119.75°、35°)の水晶基板上にオイラー角(0°、180°、0°)のZnO薄膜を形成したときのレイリー波の電気機械結合係数 K^2



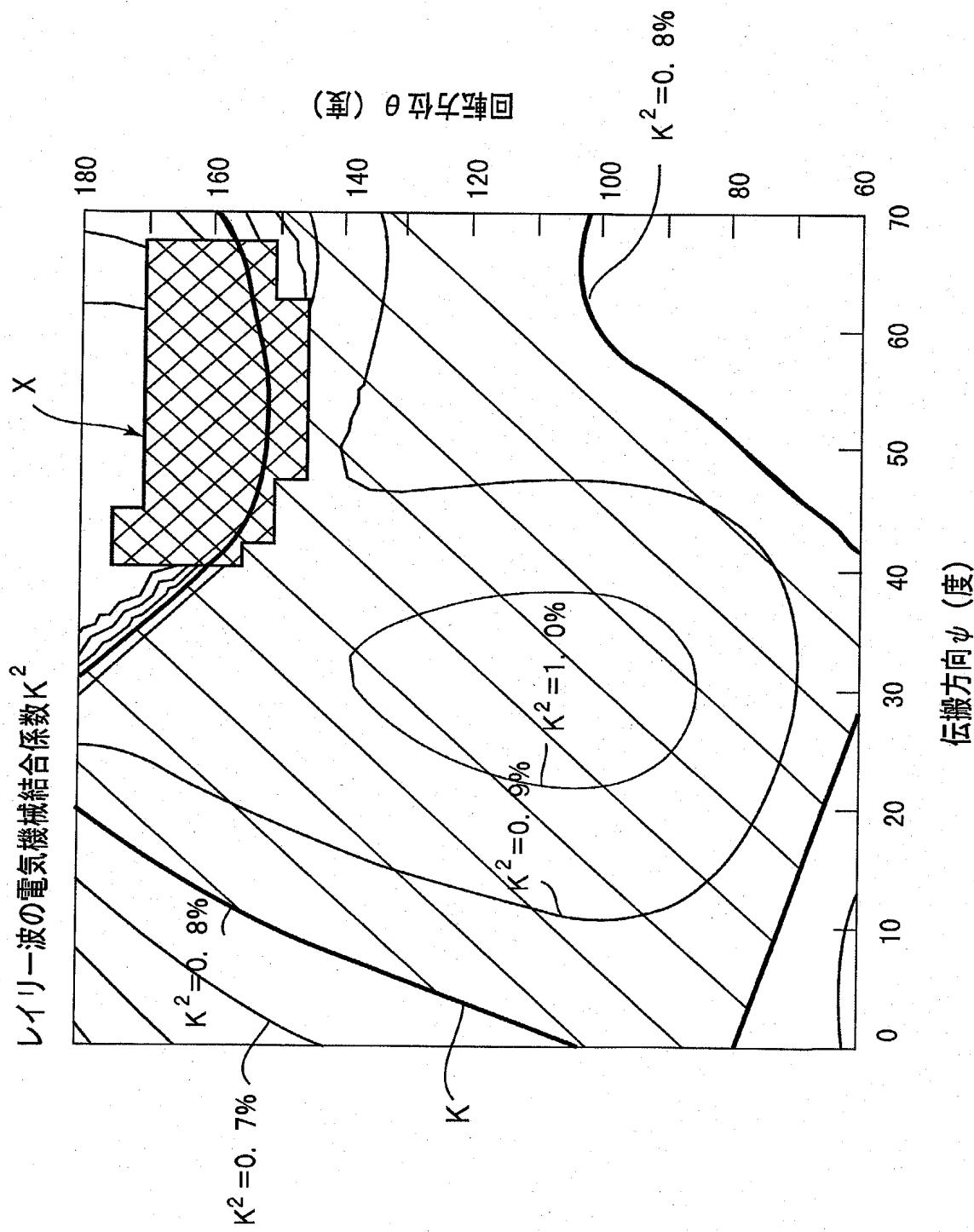
【図6】



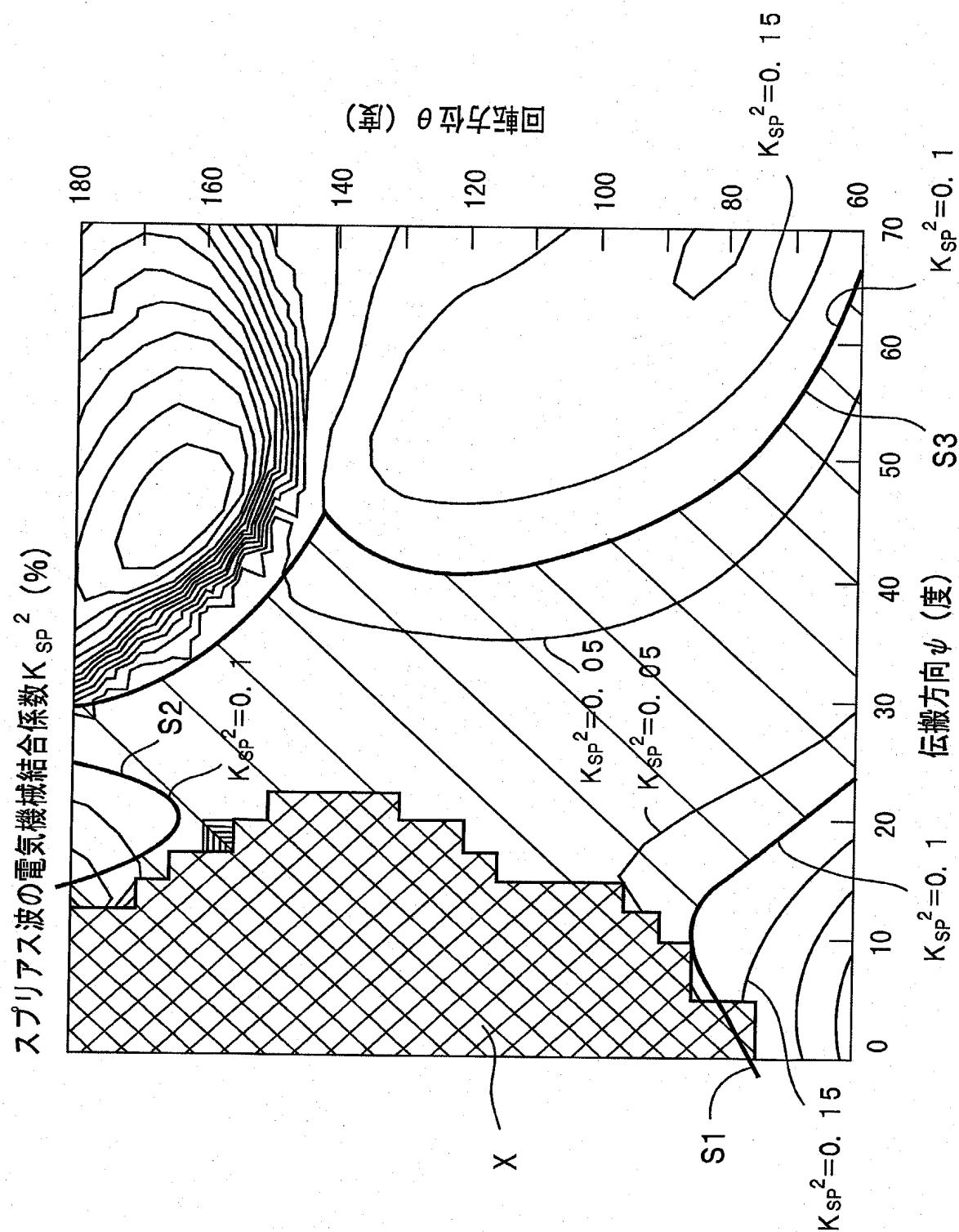
【図7】



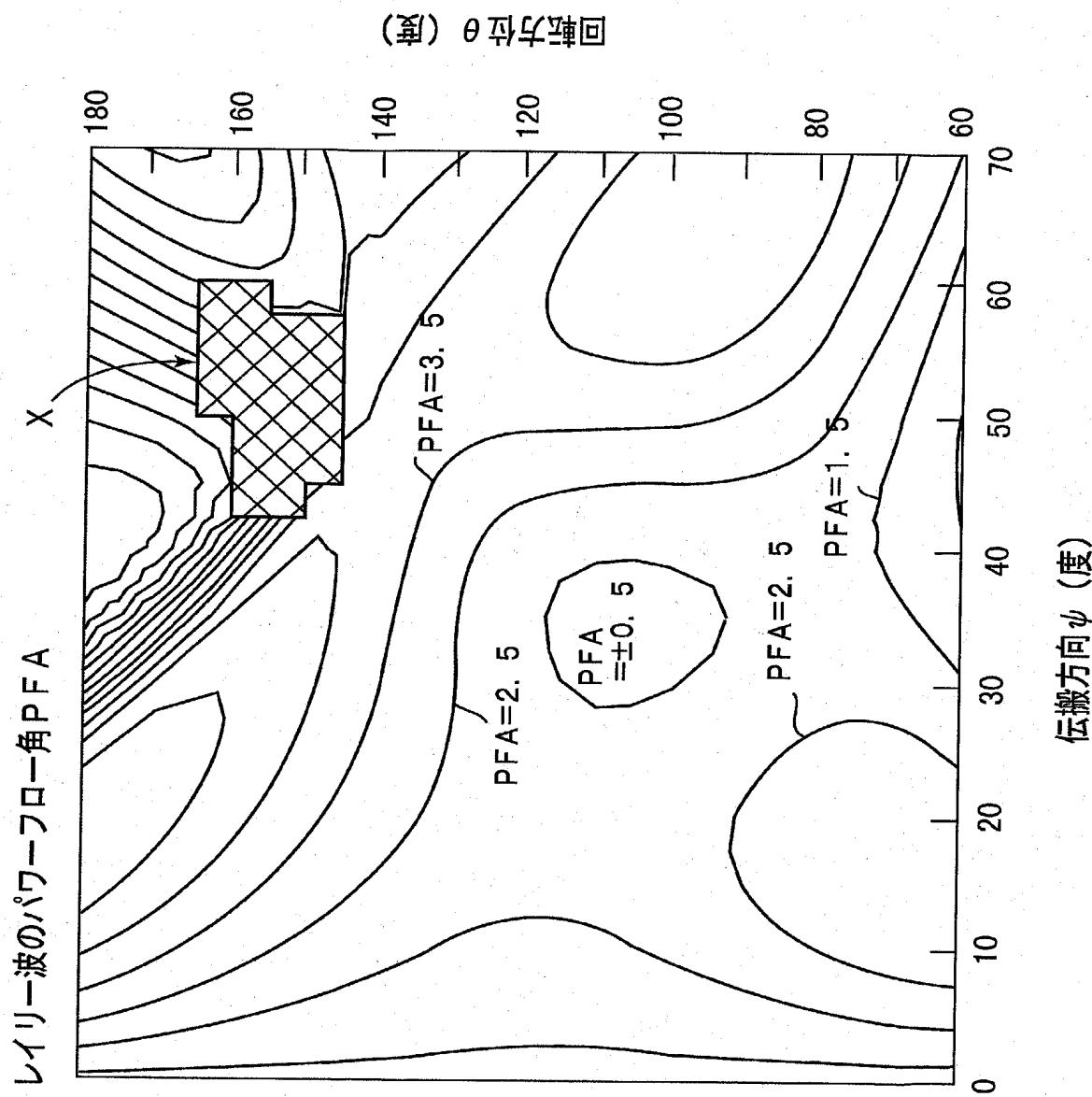
【図8】



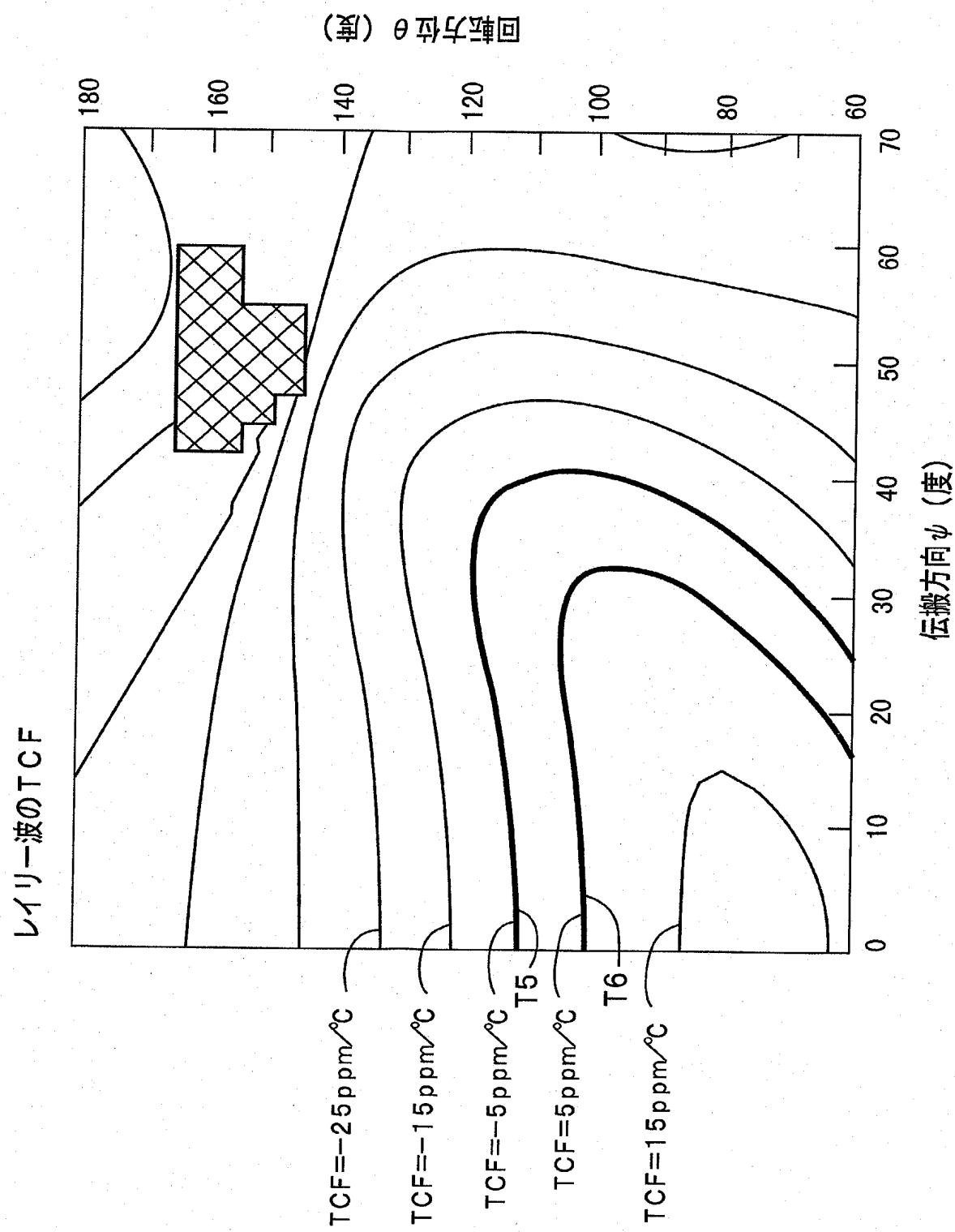
【図9】



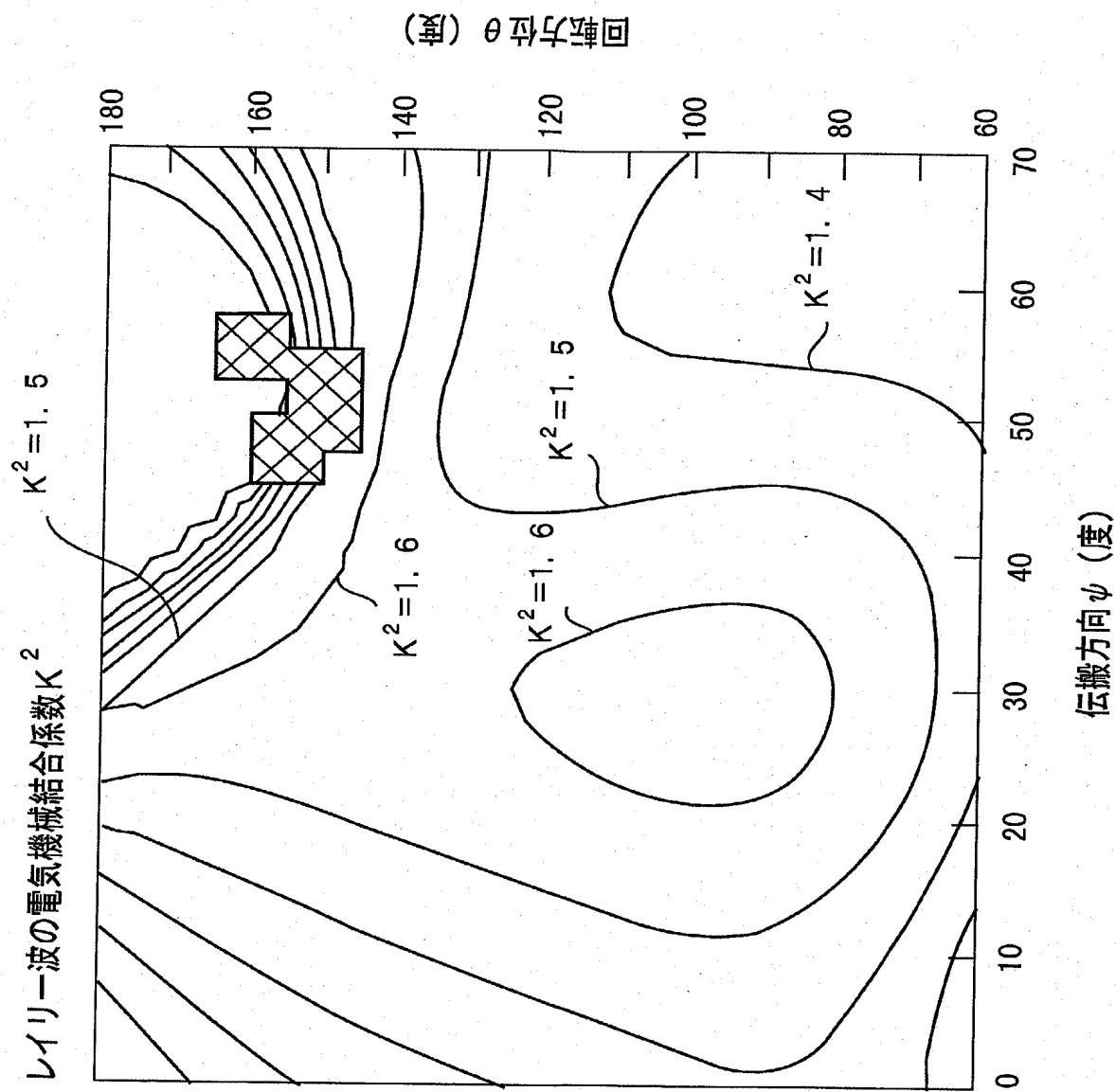
【図10】



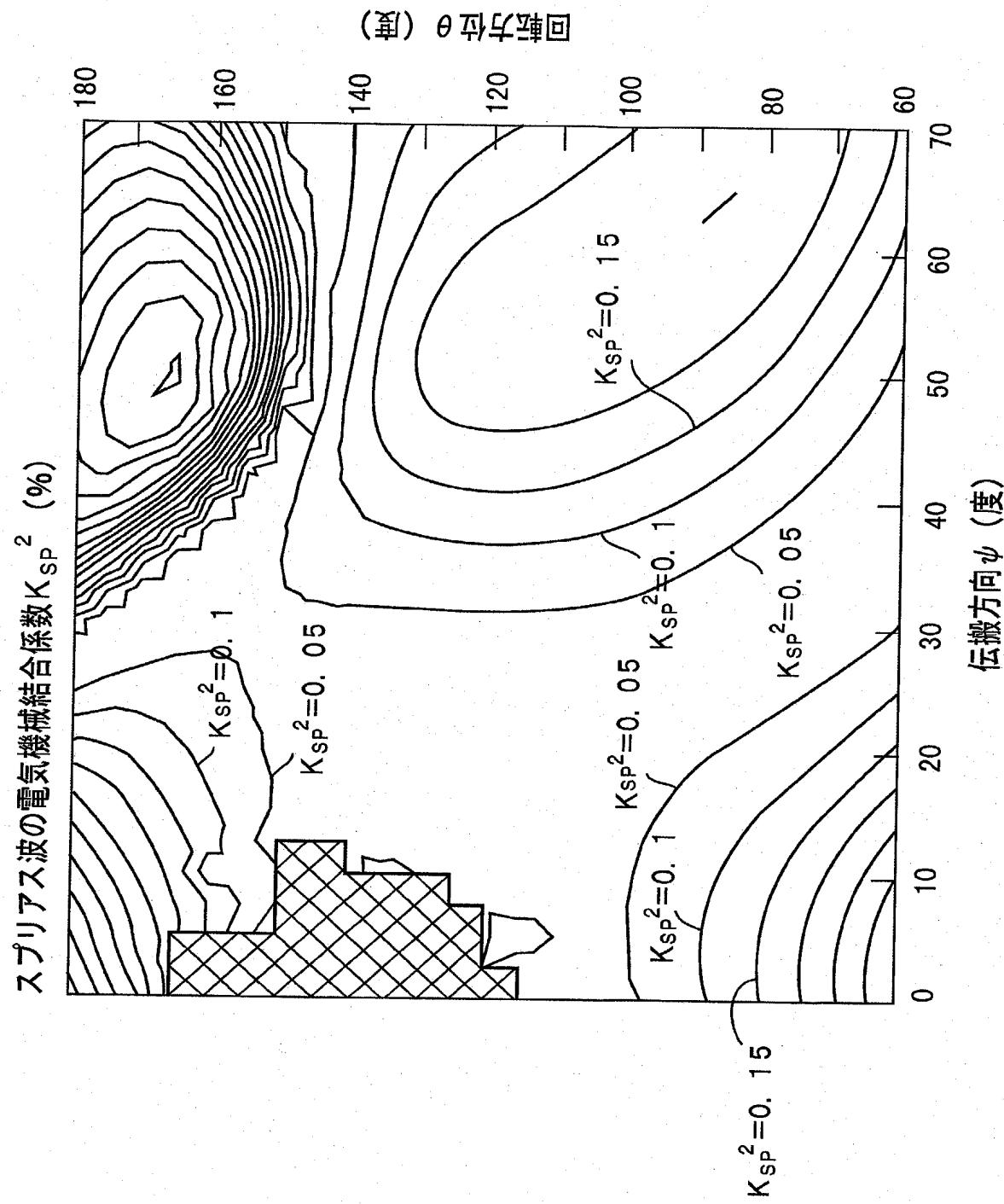
【図11】



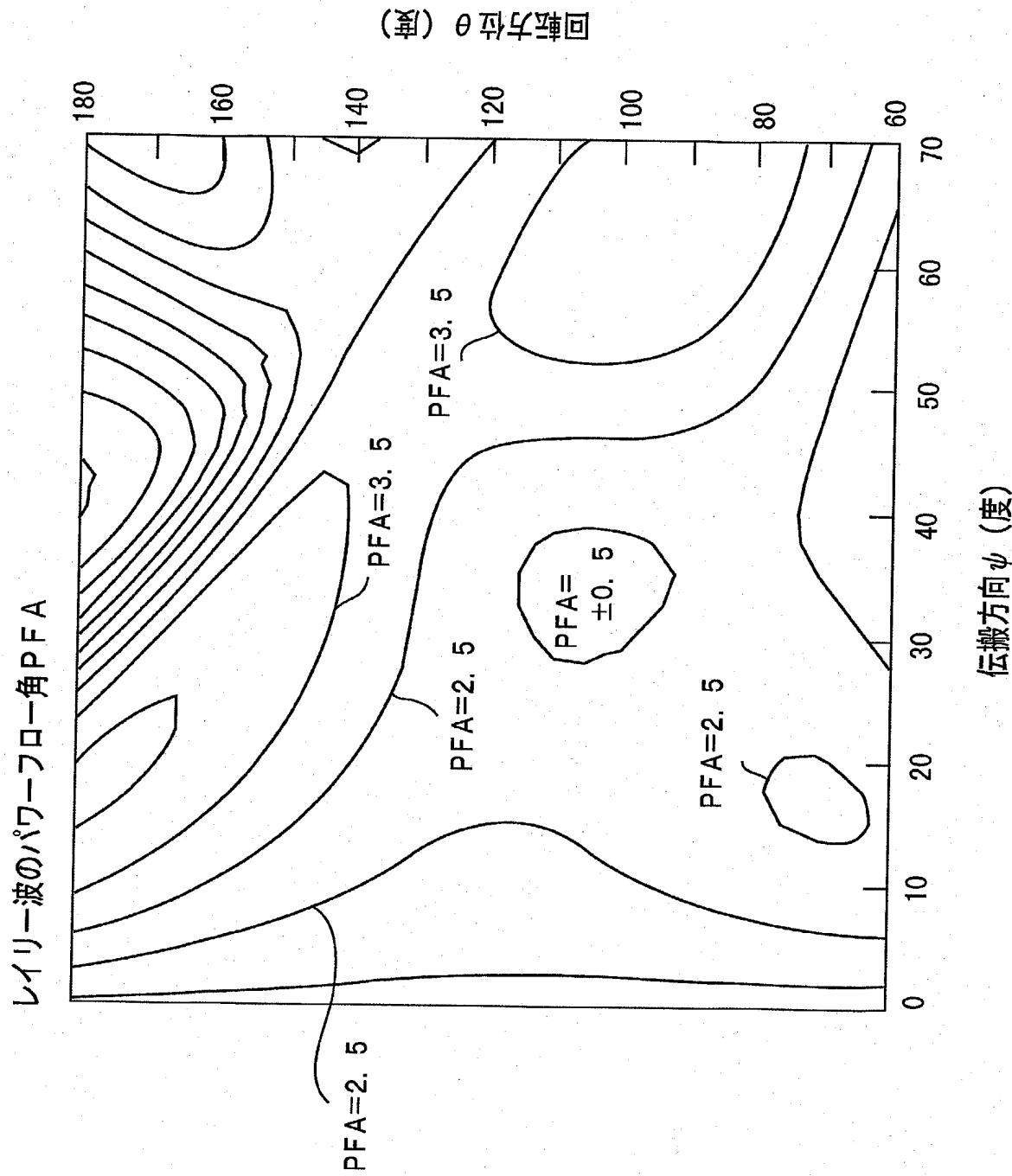
【図12】



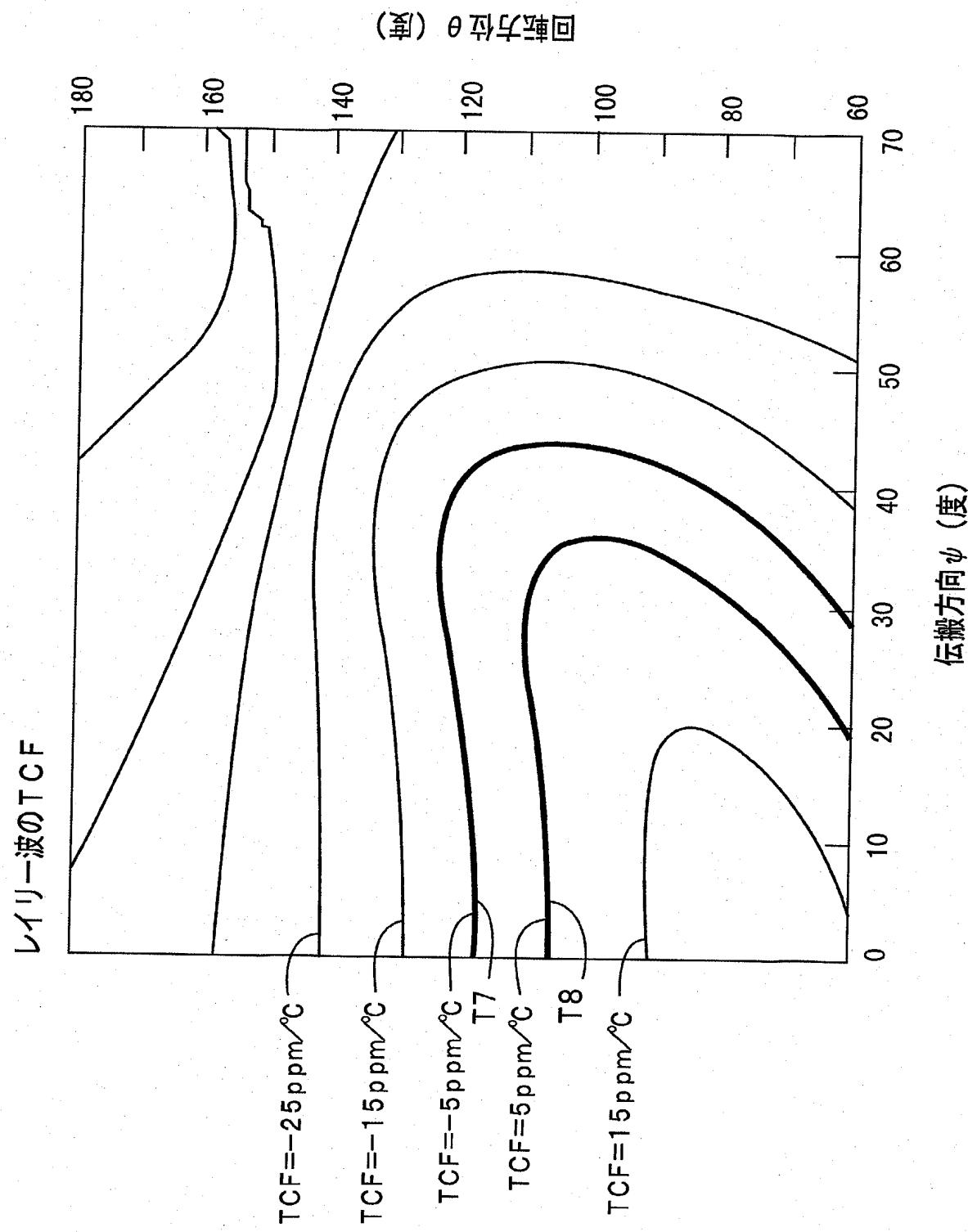
【図13】



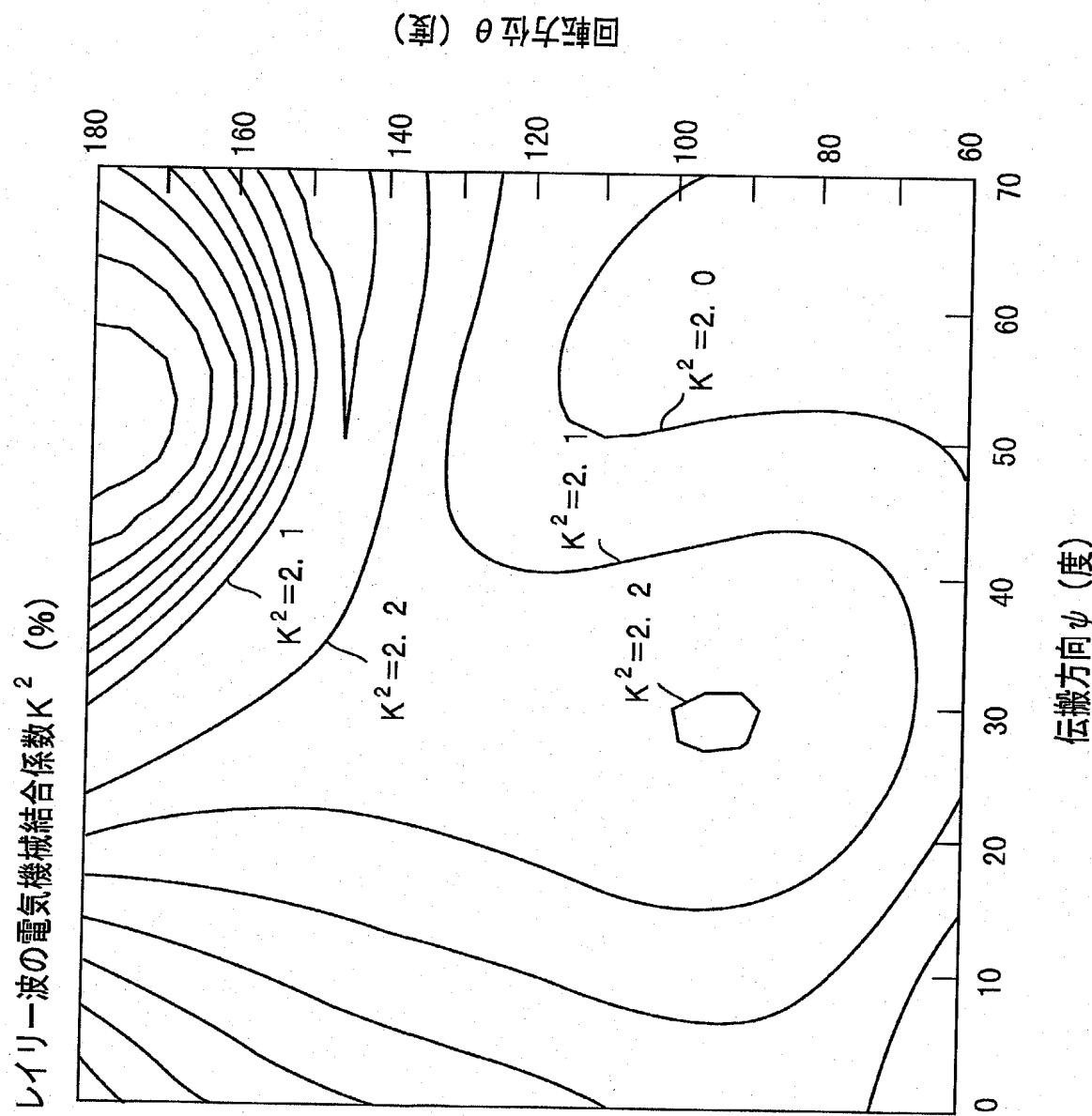
【図14】



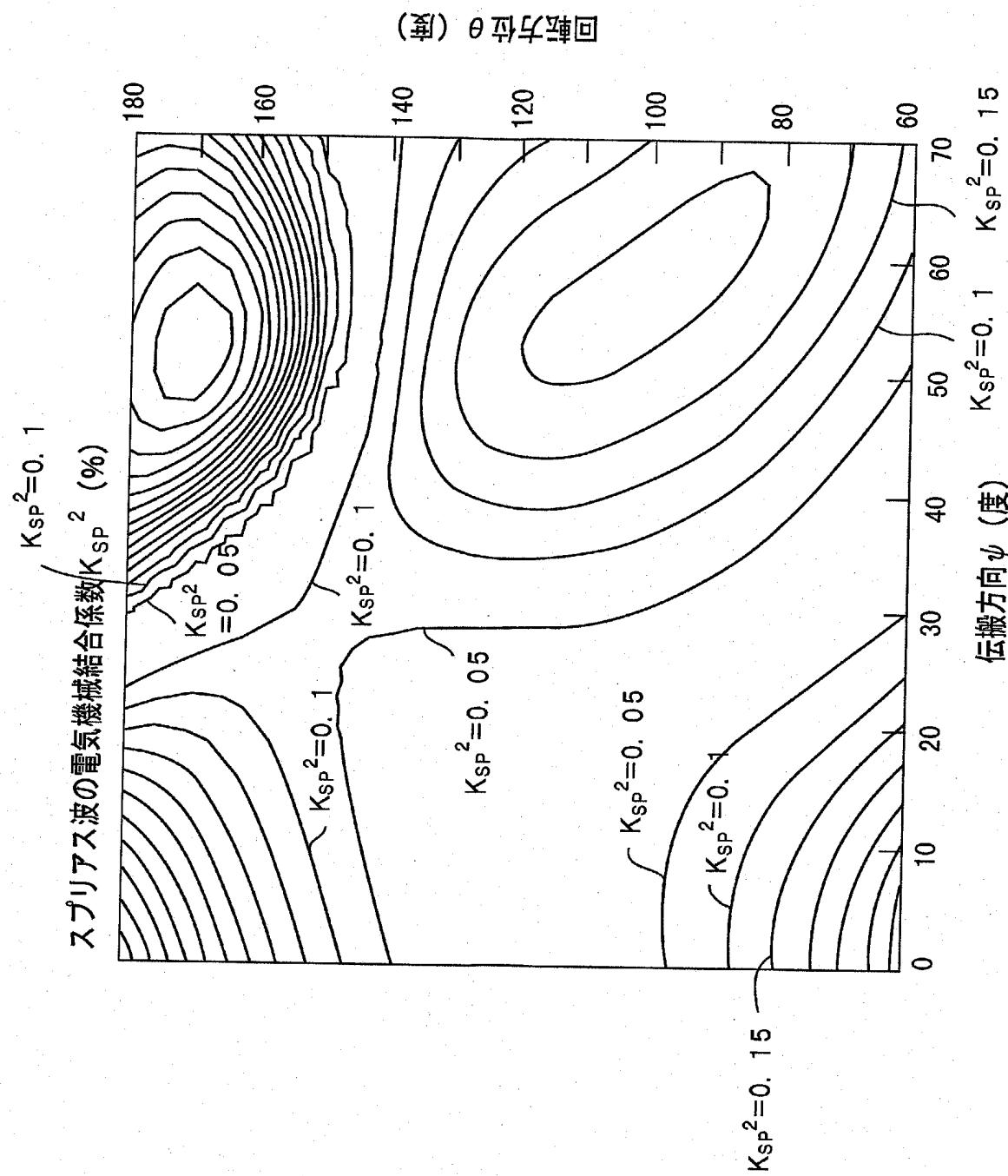
【図15】



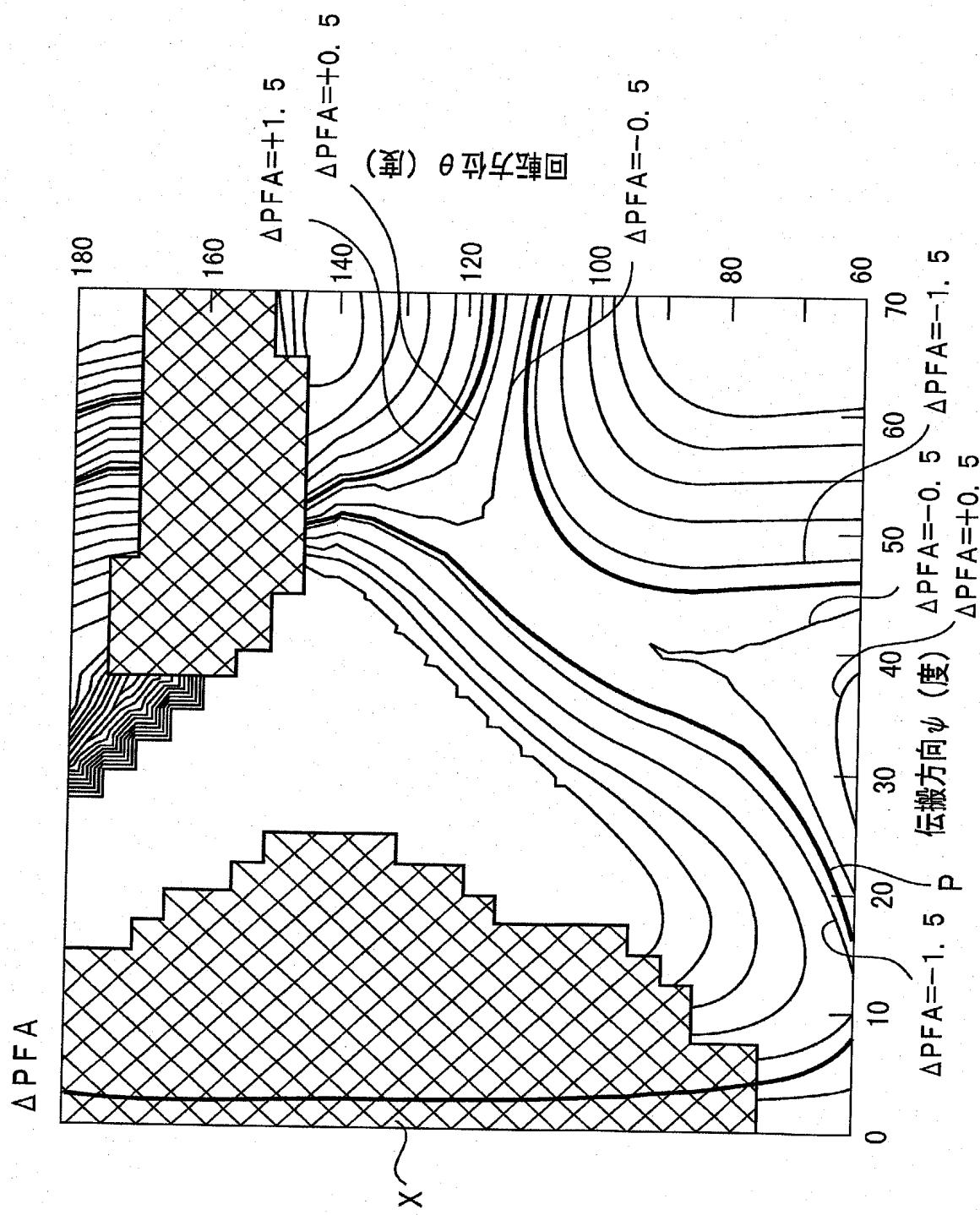
【図16】



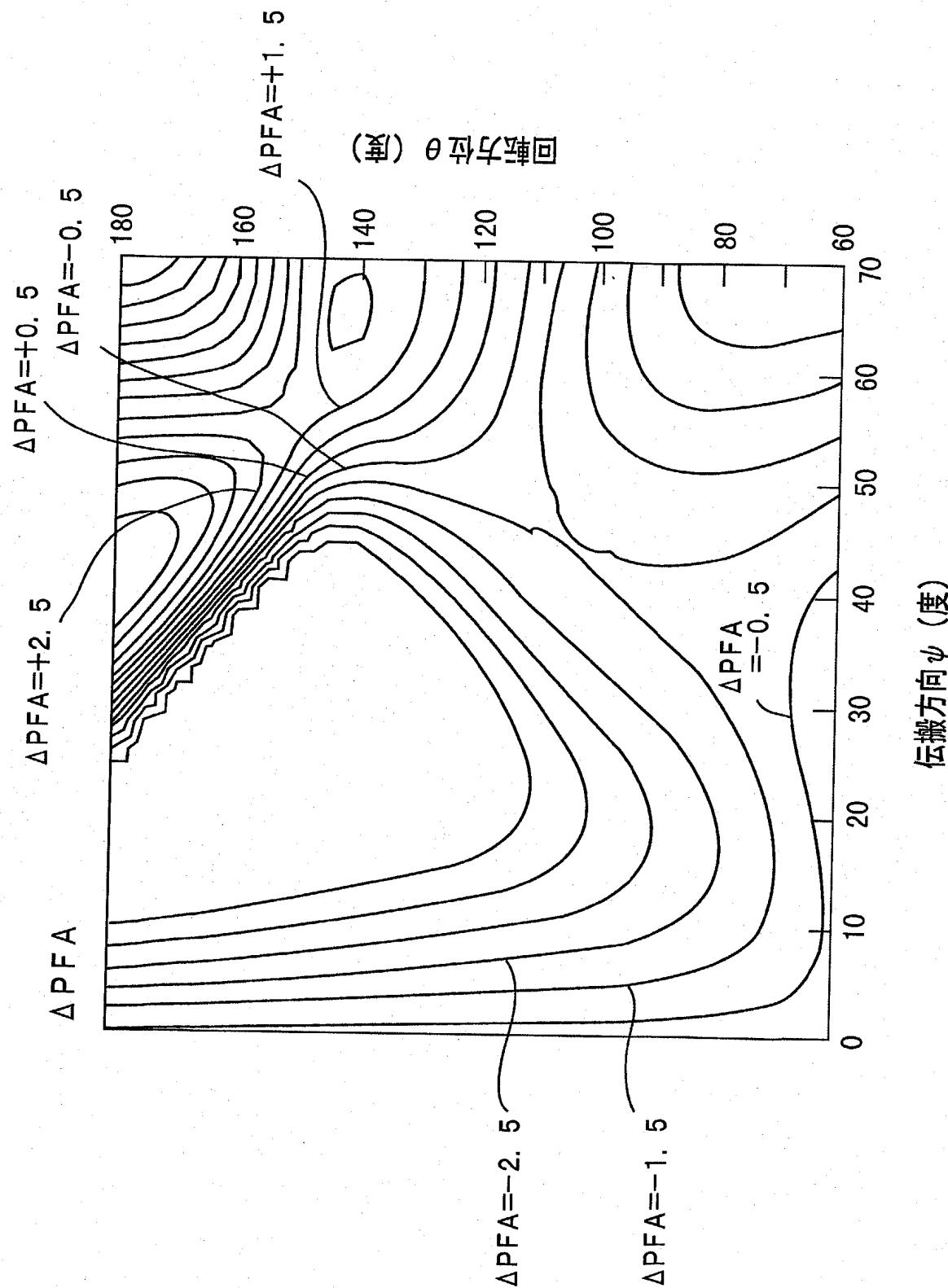
【図17】



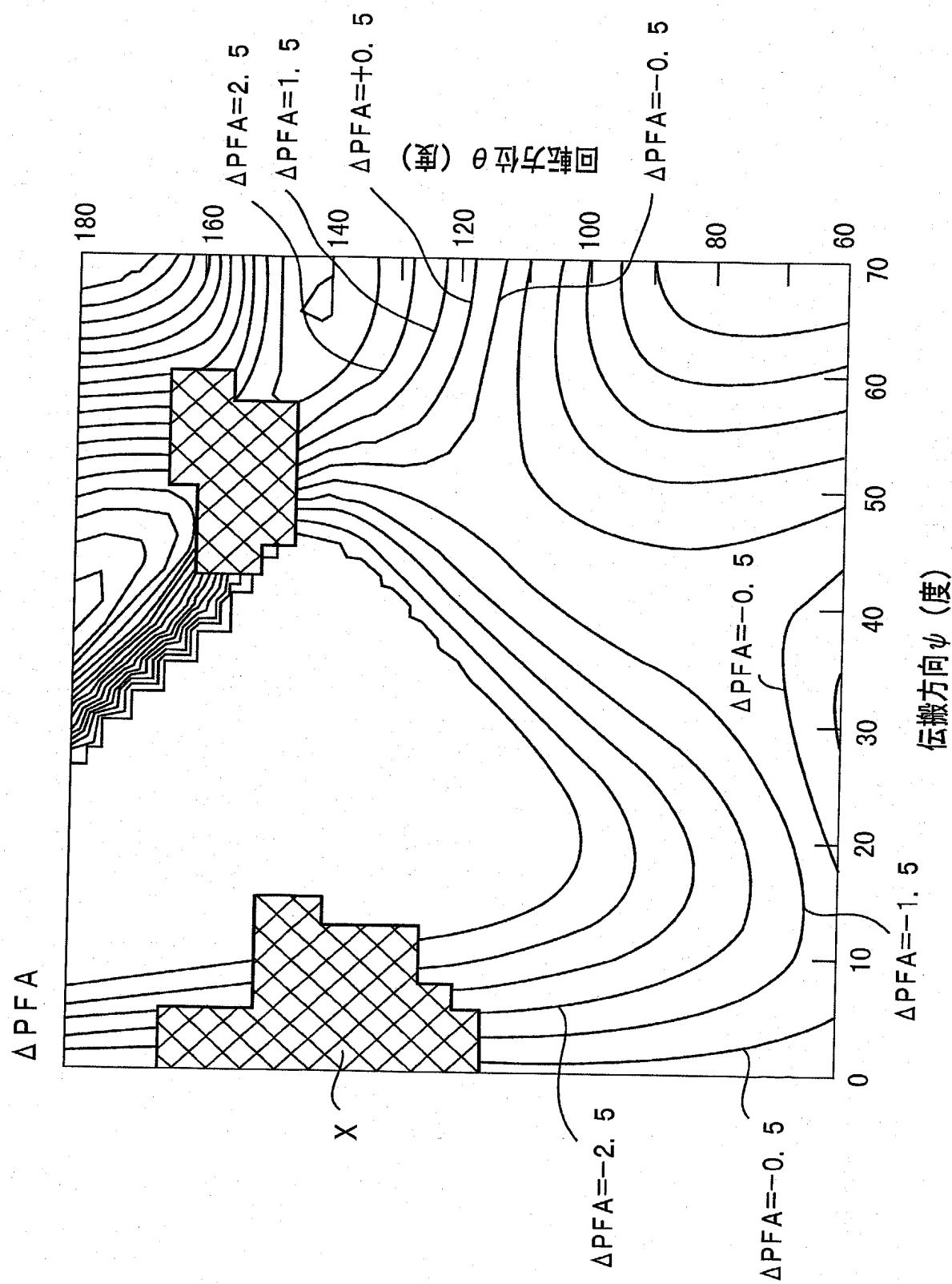
【図18】



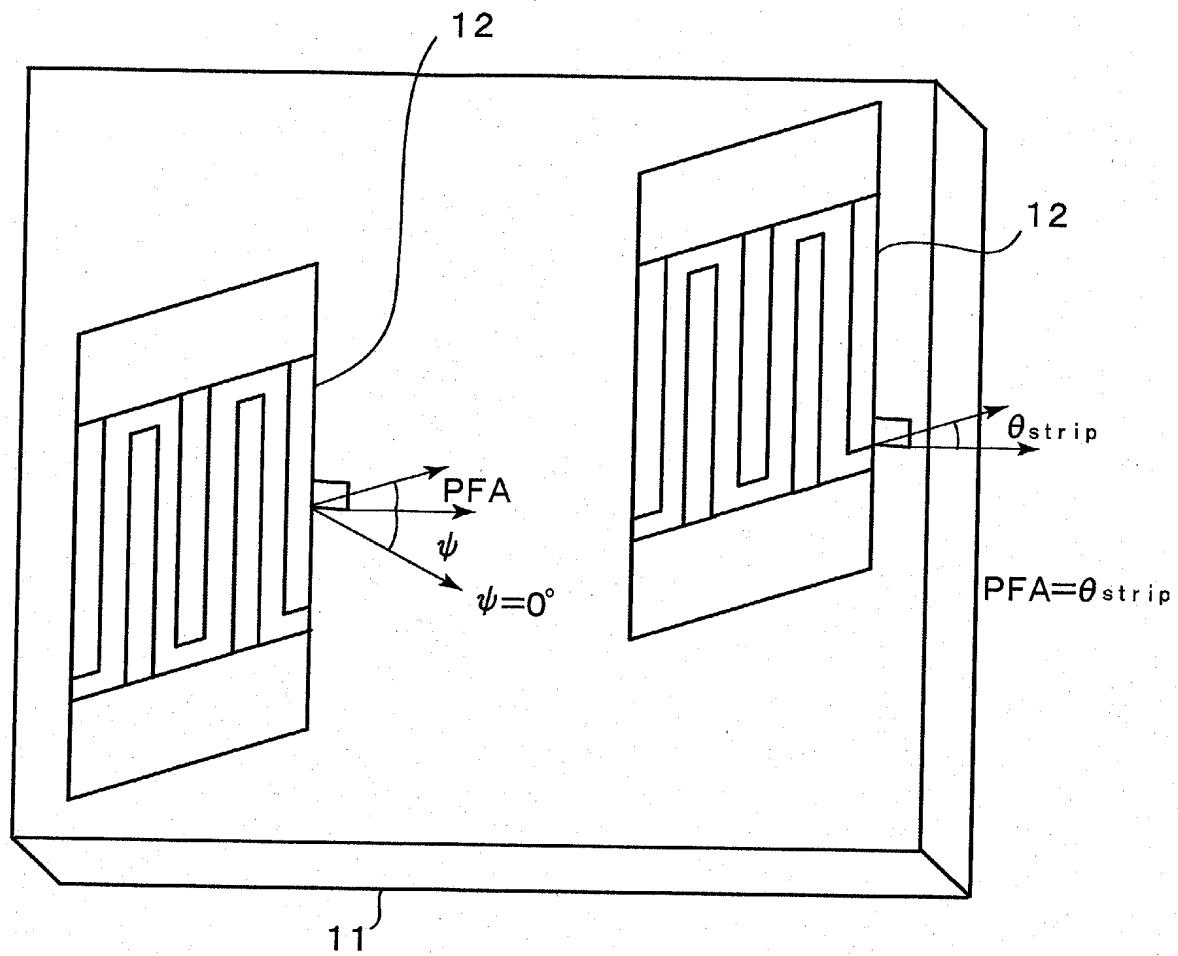
【図19】



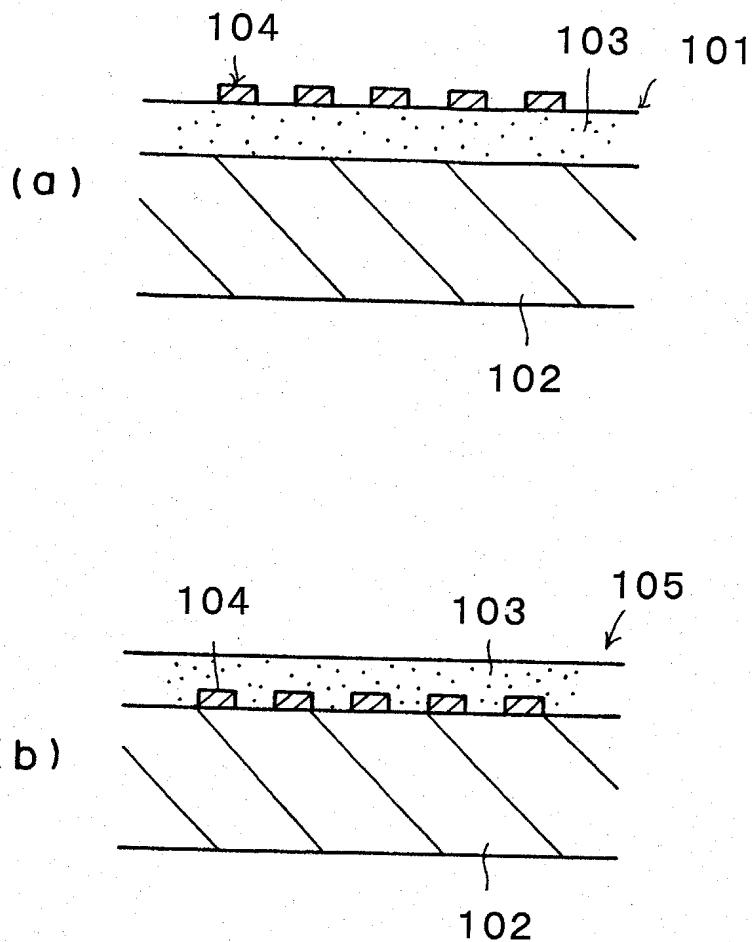
【図20】



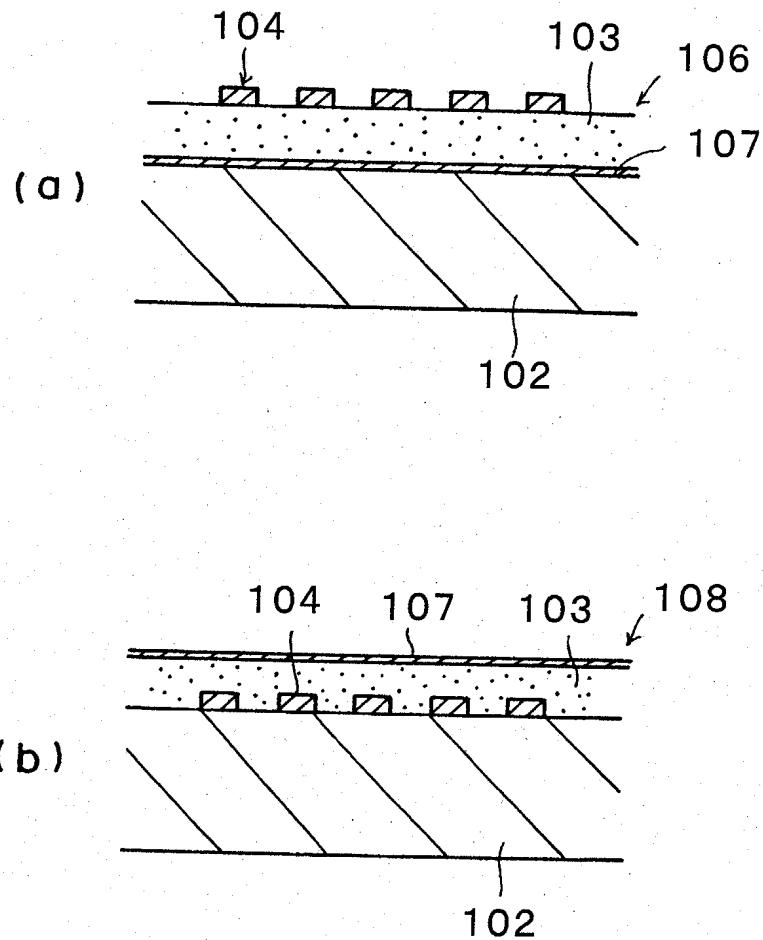
【図21】



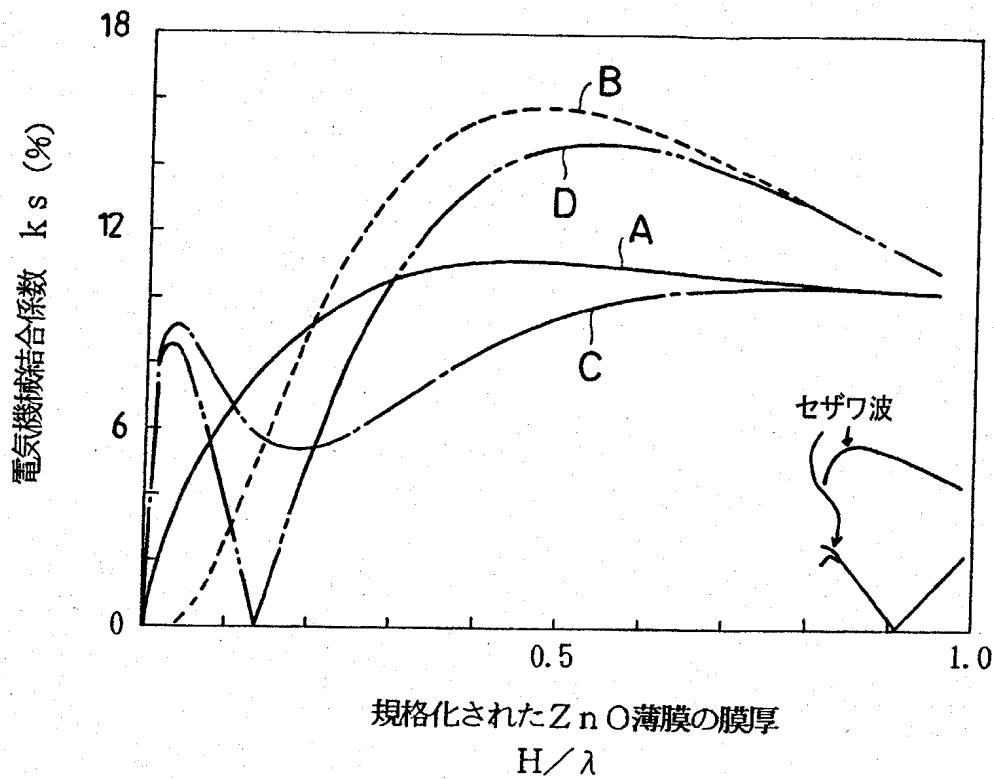
【図22】



【図23】

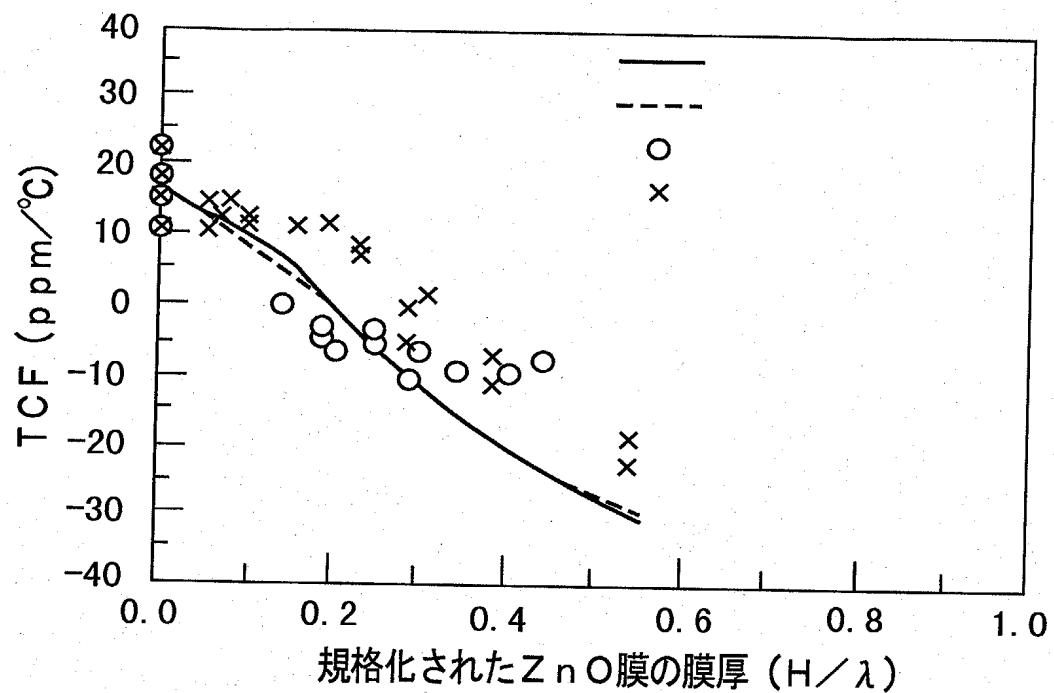


【図24】

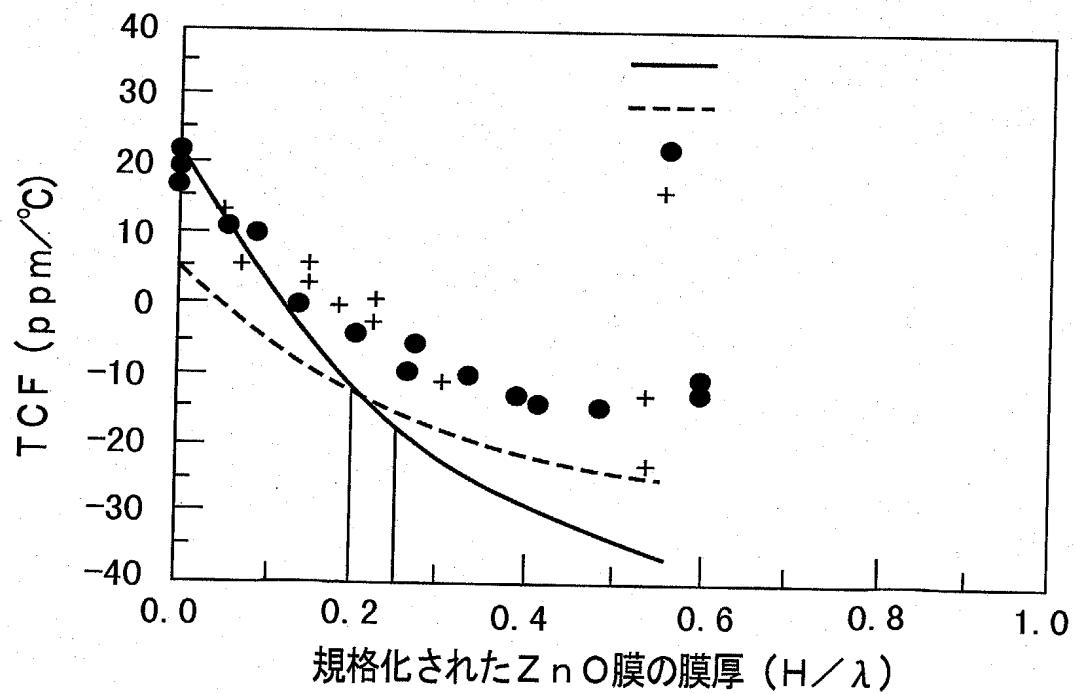


【図25】

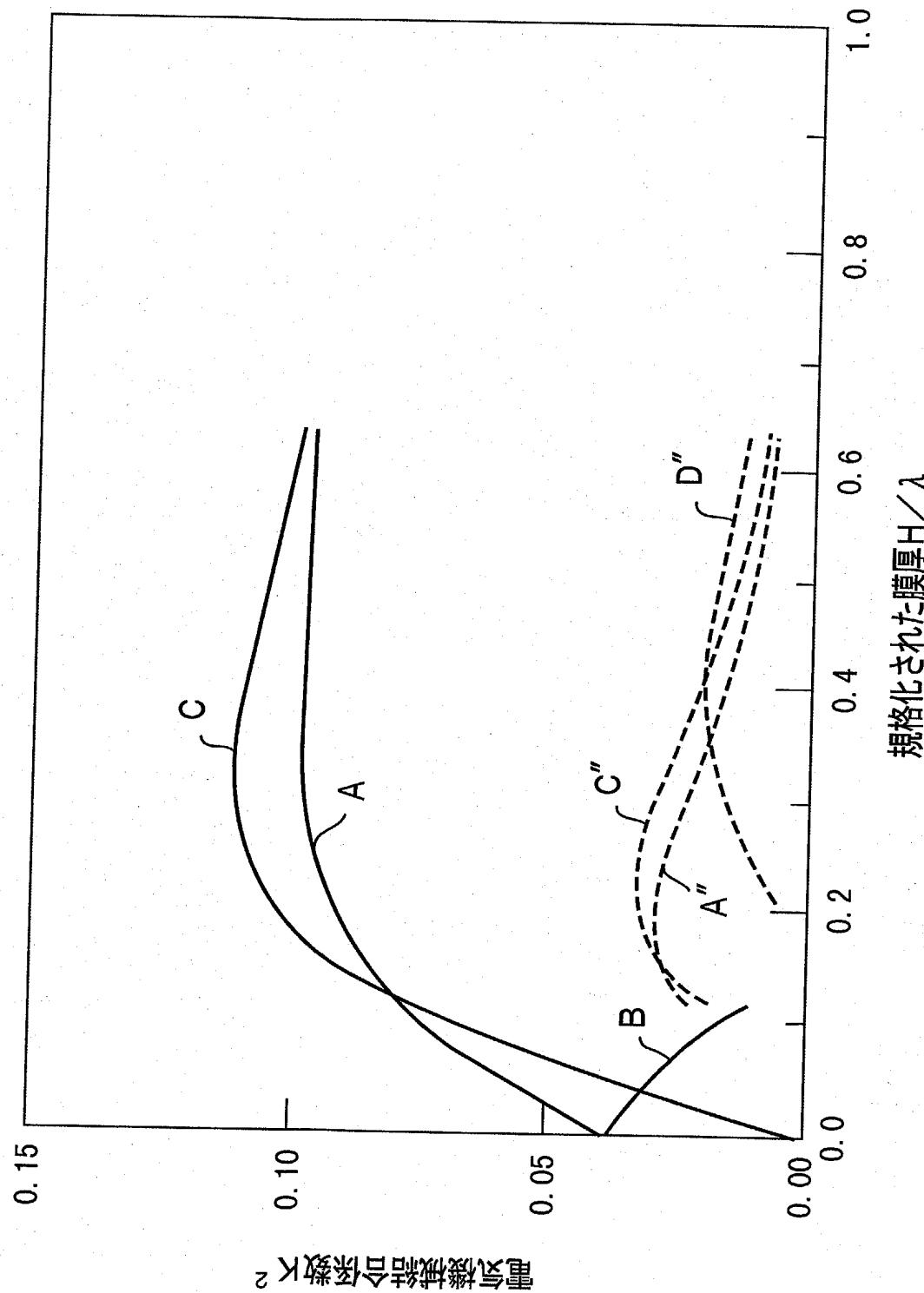
(a)



(b)



【図26】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 水晶基板に圧電薄膜を形成した表面波装置において、レイリー波の電気機械結合係数 K^2 を拡大し得る表面波装置を提供する。

【解決手段】 水晶基板2上に、圧電薄膜5が形成されており、水晶基板2と圧電薄膜5との界面にくし歯電極3a～4bが形成されており、圧電薄膜5の規格化膜厚 H/λ が0.05以上とされている表面波装置1。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号 [000006231]

1. 変更年月日 1990年 8月28日

[変更理由] 新規登録

住 所 京都府長岡京市天神二丁目26番10号

氏 名 株式会社村田製作所